

S-85S0P系列导入了本公司独自的低消耗功率控制和COT (Constant On-Time) 控制, 实现了极低消耗电流工作 (静止时电流260 nA) 和高速过渡响应。它可通过PFM控制进行工作。在宽负载电流范围内可实现高效率, 大力支持装载小型电池的移动设备以及可穿戴式设备的长时间驱动。

S-85S0P系列备有电源分压输出功能。电源分压输出功能是指把DC-DC转换器的输入电压 ( $V_{IN}$ ) 分压为 $V_{IN}/2$ 或 $V_{IN}/3$ , 然后输出此电压的功能。例如, 利用此功能可直接连接低压微机的A/D转换器, 微机可监视电池电压。

## ■ 特点

### DC-DC转换器部分

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| • 消耗电流极低 :              | 静止时电流260 nA  |
| • 效率 (100 $\mu$ A负载时) : | 90.5%  |
| • 高速过渡响应 :              | COT控制  |
| • 输入电压 :                | 2.2 V ~ 5.5 V  |
| • 输出电压 :                | 0.7 V ~ 2.5 V, 进阶单位为0.05 V<br>2.6 V ~ 3.9 V, 进阶单位为0.1 V  |
| • 输出电压精度 :              | $\pm 1.5\%$ ( $1.0\text{ V} \leq V_{OUT} \leq 3.9\text{ V}$ )<br>$\pm 15\text{ mV}$ ( $0.7\text{ V} \leq V_{OUT} < 1.0\text{ V}$ ) |
| • 高侧端功率MOS FET导通电阻 :    | 420 m $\Omega$   |
| • 低侧端功率MOS FET导通电阻 :    | 320 m $\Omega$   |
| • 软启动功能:                | 1 ms (典型值)   |
| • 欠压锁定功能 (UVLO) :       | 1.8 V (典型值) (检测电压)   |
| • 热敏关闭功能 :              | 135°C (典型值) (检测温度)   |
| • 过载电流保护功能 :            | 300 mA (L = 2.2 $\mu$ H时)  |
| • 自动复归型短路保护功能 :         | Hiccup控制   |
| • 输入、输出电容器 :            | 可使用陶瓷电容器   |

### 电源分压部分

- |           |  |
|-----------|--|
| • 低消耗电流 : | 280 nA (典型值)                                       |
| • 输入电压 :  | 1.5 V ~ 5.5 V                                      |
| • 输出电压 :  | $V_{IN}/2$ (S-85S0PCxx)<br>$V_{IN}/3$ (S-85S0PDxx) |

### 整体部分

- |                     |  |
|---------------------|--|
| • 工作温度范围 :          | $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$ |
| • 无铅 (Sn 100%)、无卤素: |  |

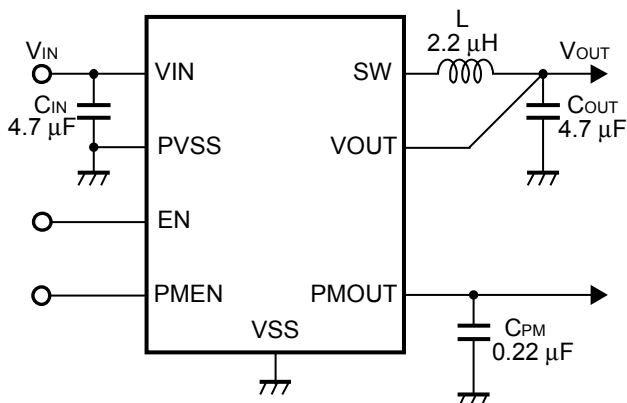
## ■ 用途

- 可穿戴式设备
- 蓝牙设备
- 无线传感器网络设备
- 医疗保健设备
- 智能型电表
- 便携游戏机设备

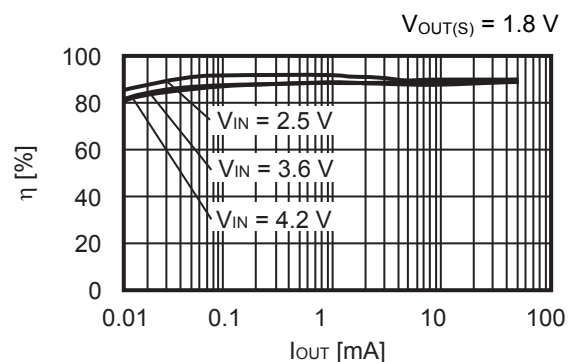
## ■ 封装

- SNT-8A  
(2.46 mm  $\times$  1.97 mm  $\times$  t0.5 mm (最大值))

## ■ 基本应用电路



## ■ 效率



■ 框图

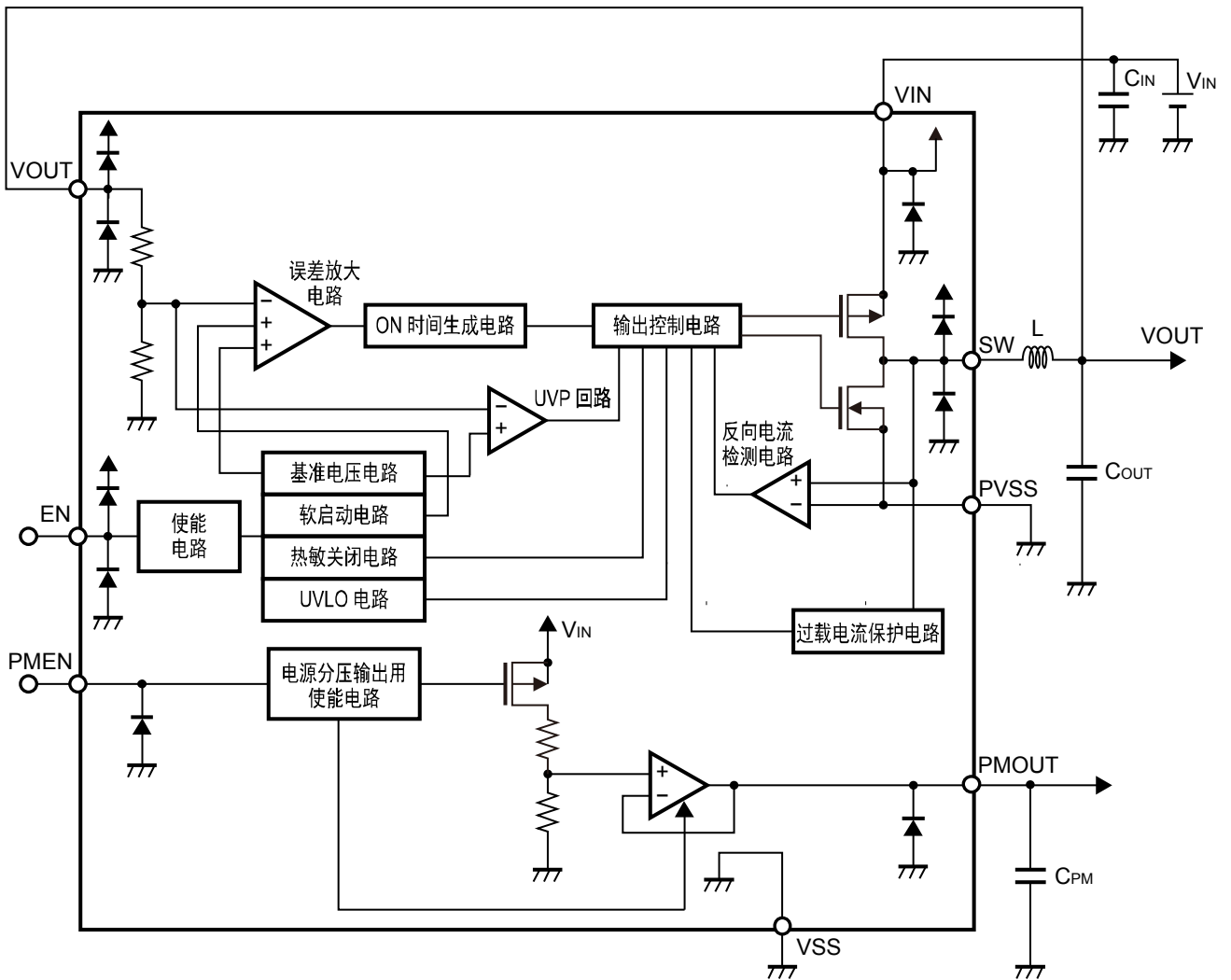
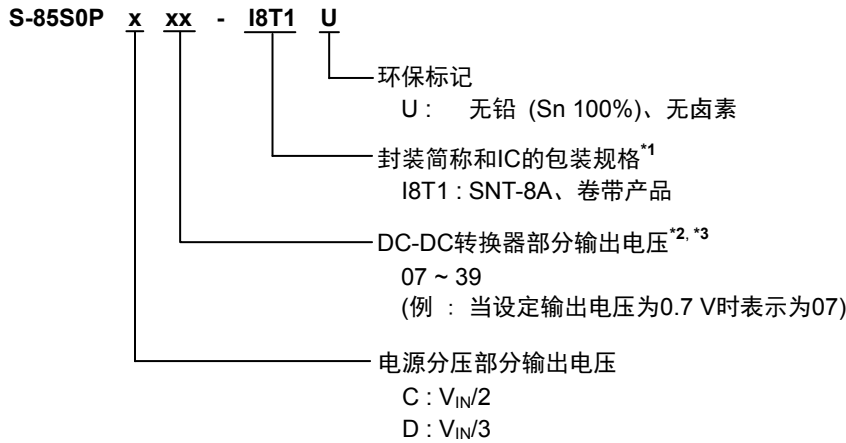


图1

## ■ 产品型号的构成

关于S-85S0P系列，用户可根据用途选择以及指定电源分压部分输出电压、DC-DC转换器部分输出电压。关于产品名中的字符串含义请参阅 "1. 产品名"、关于封装图面请参阅 "2. 封装"、关于具体的产品名请参阅 "3. 产品名目录"。

### 1. 产品名



\*1. 请参阅卷带图。

\*2. 请参阅 "3. 产品名目录"。

\*3. 在0.7 V ~ 2.5 V的范围内，也可设定0.05 V进阶单位的产品。用户需要时，请向本公司营业部咨询。

### 2. 封装

表1 封装图纸号码

封装名	外形尺寸图	卷带图	带卷图	焊盘图
SNT-8A	PH008-A-P-SD	PH008-A-C-SD	PH008-A-R-SD	PH008-A-L-SD

3. 产品名目录

表2

输出电压 (V <sub>OUT</sub> )	S-85S0PCxx	S-85S0PDxx
0.7 V ± 15 mV	S-85S0PC07-I8T1U	S-85S0PD07-I8T1U
0.8 V ± 15 mV	S-85S0PC08-I8T1U	S-85S0PD08-I8T1U
0.9 V ± 15 mV	S-85S0PC09-I8T1U	S-85S0PD09-I8T1U
1.0 V ± 1.5%	S-85S0PC10-I8T1U	S-85S0PD10-I8T1U
1.1 V ± 1.5%	S-85S0PC11-I8T1U	S-85S0PD11-I8T1U
1.2 V ± 1.5%	S-85S0PC12-I8T1U	S-85S0PD12-I8T1U
1.3 V ± 1.5%	S-85S0PC13-I8T1U	S-85S0PD13-I8T1U
1.4 V ± 1.5%	S-85S0PC14-I8T1U	S-85S0PD14-I8T1U
1.5 V ± 1.5%	S-85S0PC15-I8T1U	S-85S0PD15-I8T1U
1.6 V ± 1.5%	S-85S0PC16-I8T1U	S-85S0PD16-I8T1U
1.7 V ± 1.5%	S-85S0PC17-I8T1U	S-85S0PD17-I8T1U
1.8 V ± 1.5%	S-85S0PC18-I8T1U	S-85S0PD18-I8T1U
1.9 V ± 1.5%	S-85S0PC19-I8T1U	S-85S0PD19-I8T1U
2.0 V ± 1.5%	S-85S0PC20-I8T1U	S-85S0PD20-I8T1U
2.1 V ± 1.5%	S-85S0PC21-I8T1U	S-85S0PD21-I8T1U
2.2 V ± 1.5%	S-85S0PC22-I8T1U	S-85S0PD22-I8T1U
2.3 V ± 1.5%	S-85S0PC23-I8T1U	S-85S0PD23-I8T1U
2.4 V ± 1.5%	S-85S0PC24-I8T1U	S-85S0PD24-I8T1U
2.5 V ± 1.5%	S-85S0PC25-I8T1U	S-85S0PD25-I8T1U
2.6 V ± 1.5%	S-85S0PC26-I8T1U	S-85S0PD26-I8T1U
2.7 V ± 1.5%	S-85S0PC27-I8T1U	S-85S0PD27-I8T1U
2.8 V ± 1.5%	S-85S0PC28-I8T1U	S-85S0PD28-I8T1U
2.9 V ± 1.5%	S-85S0PC29-I8T1U	S-85S0PD29-I8T1U
3.0 V ± 1.5%	S-85S0PC30-I8T1U	S-85S0PD30-I8T1U
3.1 V ± 1.5%	S-85S0PC31-I8T1U	S-85S0PD31-I8T1U
3.2 V ± 1.5%	S-85S0PC32-I8T1U	S-85S0PD32-I8T1U
3.3 V ± 1.5%	S-85S0PC33-I8T1U	S-85S0PD33-I8T1U
3.4 V ± 1.5%	S-85S0PC34-I8T1U	S-85S0PD34-I8T1U
3.5 V ± 1.5%	S-85S0PC35-I8T1U	S-85S0PD35-I8T1U
3.6 V ± 1.5%	S-85S0PC36-I8T1U	S-85S0PD36-I8T1U
3.7 V ± 1.5%	S-85S0PC37-I8T1U	S-85S0PD37-I8T1U
3.8 V ± 1.5%	S-85S0PC38-I8T1U	S-85S0PD38-I8T1U
3.9 V ± 1.5%	S-85S0PC39-I8T1U	S-85S0PD39-I8T1U

备注 用户需要上述输出电压值以外的产品时，请向本公司营业部咨询。

■ 引脚排列图

1. SNT-8A

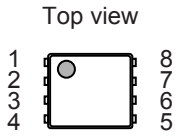


图2

表3

引脚号	符号	描述
1	PMOUT	电源分压部分输出端子
2	VOUT	输出电压端子
3	VSS	GND端子
4	SW	外部电感器连接端子
5	PVSS	电源GND端子
6	VIN	电源端子
7	EN	使能端子 "H" : 有效 (通常工作) "L" : 无效 (待机)
8	PMEN	电源分压输出用使能端子 "H" : 有效 (通常工作) "L" : 无效 (待机)

■ 绝对最大额定值

表4

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C, V<sub>SS</sub> = 0 V)

项目		符号	绝对最大额定值	单位
VIN端子电压		V <sub>IN</sub>	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>SS</sub> + 6.0	V
EN端子电压	DC-DC转换器部分	V <sub>EN</sub>	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>IN</sub> + 0.3 ≤ V <sub>SS</sub> + 6.0	V
PMEN端子电压	电源分压部分	V <sub>PMEN</sub>	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>SS</sub> + 6.0	V
VOOUT端子电压	DC-DC转换器部分	V <sub>OUT</sub>	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>IN</sub> + 0.3 ≤ V <sub>SS</sub> + 6.0	V
PMOUT端子电压	电源分压部分	V <sub>PMOUT</sub>	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>IN</sub> + 0.3 ≤ V <sub>SS</sub> + 6.0	V
SW端子电压		V <sub>SW</sub>	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>IN</sub> + 0.3 ≤ V <sub>SS</sub> + 6.0	V
PVSS端子电压		V <sub>PVSS</sub>	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>SS</sub> + 0.3 ≤ V <sub>SS</sub> + 6.0	V
工作环境温度		T <sub>opr</sub>	-40 ~ +85	°C
保存温度		T <sub>stg</sub>	-40 ~ +125	°C

注意 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值，有可能造成产品劣化等物理性损伤。

■ 热敏电阻值

表5

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	
结至环境热阻*1	θ <sub>JA</sub>	SNT-8A	Board A	-	211	-	°C/W
			Board B	-	173	-	°C/W
			Board C	-	-	-	°C/W
			Board D	-	-	-	°C/W
			Board E	-	-	-	°C/W

\*1. 测定环境：遵循JEDEC STANDARD JESD51-2A标准

备注 关于详情，请参阅 "■ Power Dissipation" 和 "Test Board"。

## ■ 电气特性

### 1. DC-DC转换器部分

表6

(除特殊注明以外： $V_{IN} = 3.6 V^{*1}$ ,  $T_a = +25^{\circ}C$ )

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作时输入电压	$V_{IN}$	—	2.2	3.6	5.5	V
输出电压 <sup>*2</sup>	$V_{OUT}$	$1.0 V \leq V_{OUT} \leq 3.9 V$ , 无外接元器件	$V_{OUT(S)} \times 0.985$	$V_{OUT(S)}$	$V_{OUT(S)} \times 1.015$	V
		$0.7 V \leq V_{OUT} < 1.0 V$ , 无外接元器件	$V_{OUT(S)} - 0.015$	$V_{OUT(S)}$	$V_{OUT(S)} + 0.015$	V
休眠时消耗电流	$I_{SSS}$	$V_{EN} = 0 V$	—	1	100	nA
静止时消耗电流	$I_{SS1}$	$V_{OUT} = V_{OUT(S)} + 0.1 V$ , $V_{EN} = V_{IN}$ , 无外接元器件、切换工作停止时	—	260	500	nA
高电位输入电压	$V_{SH}$	$V_{IN} = 2.2 V \sim 5.5 V$ , EN端子	1.1	—	—	V
低电位输入电压	$V_{SL}$	$V_{IN} = 2.2 V \sim 5.5 V$ , EN端子	—	—	0.3	V
高电位输入电流	$I_{SH}$	$V_{IN} = 2.2 V \sim 5.5 V$ , EN端子, $V_{EN} = V_{IN}$	-100	—	100	nA
低电位输入电流	$I_{SL}$	$V_{IN} = 2.2 V \sim 5.5 V$ , EN端子, $V_{EN} = 0 V$	-100	—	100	nA
高侧端功率MOS FET 导通电阻	$R_{HFET}$	$I_{SW} = 100 mA$	—	420	—	mΩ
低侧端功率MOS FET 导通电阻	$R_{LFET}$	$I_{SW} = -100 mA$	—	320	—	mΩ
高侧端功率MOS FET 泄漏电流	$I_{HSW}$	$V_{IN} = 2.2 V \sim 5.5 V$ , $V_{EN} = 0 V$ , $V_{SW} = 0 V$	—	1	100	nA
低侧端功率MOS FET 泄漏电流	$I_{LSW}$	$V_{IN} = 2.2 V \sim 5.5 V$ , $V_{EN} = 0 V$ , $V_{SW} = V_{IN}$	-100	1	—	nA
限制电流 <sup>*3</sup>	$I_{LIM}$	$L = 2.2 \mu H$	—	300	—	mA
ON时间 <sup>*4</sup>	$t_{ON}$	$t_{ON(S)} = 1 \mu s \times V_{OUT}/V_{IN}$ , $V_{OUT} = V_{OUT(S)} \times 0.9$	$t_{ON(S)}/1.3$	$t_{ON(S)}$	$t_{ON(S)}/0.7$	ns
最小OFF时间	$t_{OFF(MIN)}$	—	—	100	—	ns
UVLO检测电压	$V_{UVLO-}$	$V_{IN}$ 下降时	1.7	1.8	1.9	V
UVLO解除电压	$V_{UVLO+}$	$V_{IN}$ 上升时	1.9	2.0	2.1	V
UVP检测电压	$V_{UVP}$	—	—	$V_{OUT(S)} \times 0.7$	—	V
软启动等待时间	$t_{SSW}$	到 $V_{OUT}$ 开始上升为止的时间	—	1.5	—	ms
软启动时间	$t_{SS}$	从 $V_{OUT}$ 开始上升到达到90%为止的时间	—	1.0	—	ms
热敏关闭检测温度	$T_{SD}$	结点温度	—	135	—	$^{\circ}C$
热敏关闭解除温度	$T_{SR}$	结点温度	—	115	—	$^{\circ}C$

\*1.  $V_{IN} = V_{OUT(S)} + 1.0 V$  ( $V_{OUT(S)} \geq 2.6 V$ )

\*2.  $V_{OUT}$ : 实际输出电压值  
 $V_{OUT(S)}$ : 设定输出电压值

\*3. 限制电流会因所使用的电感器的L值、输入电压、输出电压的不同而发生变化。  
有关详情, 请参阅 "■ 工作说明"。

\*4.  $t_{ON}$ : 实际的ON时间  
 $t_{ON(S)}$ : 设定ON时间

2. 电源分压部分

表7

(除特殊注明以外 :  $V_{IN} = 3.6\text{ V}$ ,  $T_a = +25^\circ\text{C}$ )

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	
工作时输入电压	$V_{IN}$	-	1.5	3.6	5.5	V	
输出电压*1	$V_{PMOUT(S)}$	$-10\ \mu\text{A} \leq I_{PMOUT} \leq 10\ \mu\text{A}$	S-85S0PCxx	-	$V_{IN}/2$	-	V
			S-85S0PDxx	-	$V_{IN}/3$	-	V
负荷电流	$I_{PMOUT}$	-	-10	-	10	$\mu\text{A}$	
输出补偿电压	$V_{POF}$	$-10\ \mu\text{A} \leq I_{PMOUT} \leq 10\ \mu\text{A}$	S-85S0PCxx	-30	-	30	mV
			S-85S0PDxx	-20	-	20	mV
输出阻抗	$R_{PS}$	$-10\ \mu\text{A} \leq I_{PMOUT} \leq 10\ \mu\text{A}$	-	-	1000	$\Omega$	
上电时间	$t_{PU}$	$C_{PM} = 0.22\ \mu\text{F}$ , 无负荷	S-85S0PCxx	-	2.2	10	ms
			S-85S0PDxx	-	1.1	10	ms
工作时消耗电流*2	$I_{SS1P}$	$V_{PMEN} = V_{IN}$ , 无负荷 ( $V_{EN} = 0\text{ V}$ )	-	280	550	nA	
PMEN端子输入电压 "H"	$V_{PSH}$	通过 $V_{PMOUT}$ 输出电位来判断	1.0	-	-	V	
PMEN端子输入电压 "L"	$V_{PSL}$	通过 $V_{PMOUT}$ 输出电位来判断	-	-	0.25	V	
PMEN端子输入电流 "H"	$I_{PSH}$	$V_{PMEN} = V_{IN}$	-100	-	100	nA	
PMEN端子输入电流 "L"	$I_{PSL}$	$V_{PMEN} = 0\text{ V}$	-100	-	100	nA	
休眠时放电分路电阻	$R_{PLOW}$	$V_{PMEN} = 0\text{ V}$ , $V_{PMOUT} = 0.1\text{ V}$	-	2.8	-	k $\Omega$	

\*1.  $V_{PMOUT(S)}$ : 设定输出电压值

$V_{PMOUT(S)} + V_{POF}$ : 实际的输出电压值

\*2. 仅限电源分压部分工作时的消耗电流



## ■ 工作说明

### 1. DC-DC转换器部分

#### 1.1 高速过渡响应

DC-DC转换器的控制采用了本公司独有的COT (Constant On-Time) 控制。

S-85S0P系列通过比较器来监视输出电压 ( $V_{OUT}$ )，当 $V_{OUT}$ 降低到一定值以下时，在一定时间内高侧端功率MOS FET会为ON。当负载电流发生急剧变动，由于 $V_{OUT}$ 降低之后，高侧端功率MOS FET会为ON，从而导致 $V_{OUT}$ 上升，因此可实现高速过渡响应。

S-85S0P系列输出与 $V_{OUT}$ 成正比、与电源电压成反比的ON时间。

#### 1.2 PFM切换控制 (脉冲频率变调)

S-85S0P系列是通过PFM控制进行工作的，它可根据负载电流跳过脉冲。因此，可抑制切换的功耗，提高效率。

S-85S0P系列内置了反向电流检测电路。反向电流检测电路可监视流入电感器的电流。若电感器的最小纹波电流降低到0 mA，高侧端功率MOS FET和低侧端功率MOS FET为OFF，切换工作会被停止。由于脉冲被跳过，切换频率 ( $f_{sw}$ ) 会降低。也就是说， $I_{OUT}$ 越小切换频率越会降低，从而抑制切换的功耗。

电源电压降低后，输入输出电位差会逐渐变小，S-85S0P系列也就不再跳过脉冲。

#### 1.3 消耗电流极低

S-85S0P系列在不连续模式时，通过控制电路以及保护电路进行间歇工作，可将消耗电流抑制为260 nA (典型值)。高侧端功率MOS FET和低侧端功率MOS FET为OFF时，切换工作便会停止，在经过一定的时间后，必要的电路会开始工作。

S-85S0P系列备有欠压锁定功能 (UVLO)、热敏关闭功能、过载电流保护功能和自动复归型短路保护功能。将高侧端功率MOS FET设置为ON后，在一定期间内各种保护功能进行检测工作，因此，可实现极低的消耗电流。

#### 1.4 EN端子

用来停止或启动切换工作。将EN端子设置为 "L"，会停止包括高侧端功率MOS FET在内的内部电路的所有工作，从而抑制消耗电流。另外，对EN端子施加 $0.3\text{ V} \sim V_{IN} - 0.3\text{ V}$ 的电压时，会增加消耗电流。不使用EN端子时，请与VIN端子连接。EN端子在内部即不被上拉也不被下拉，因此请不要在浮动状态下使用。EN端子的构造如图3所示。

表8

EN端子	内部电路	VOUT端子电压
"H"	有效 (通常工作)	$V_{OUT}^{*1}$
"L"	无效 (待机)	"High-Z"

\*1. 请参阅 "■ 电气特性"、表6的\*2。

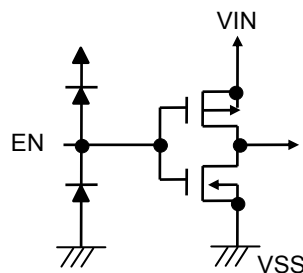


图3

### 1.5 欠压锁定功能 (UVLO)

S-85S0P系列为了防止在接通电源时的过渡状态以及因电源电压的瞬间降低而导致IC的误工作，内置了UVLO电路。若检测出UVLO状态，高侧端功率MOS FET和低侧端功率MOS FET变为OFF，SW端子变为 "High-Z"。借此，停止切换工作。另外，一旦检测出UVLO状态，软启动功能就会被复位。当UVLO状态被解除后软启动功能会开始工作。但是，其他的内部电路仍正常工作，不同于无效状态，务请注意。  
另外，为了防止因输入电压发生噪声等而导致的误工作，设置了滞后幅度。

### 1.6 热敏关闭功能

S-85S0P系列为了防止因发热而引起的对产品的破坏，内置了热敏关闭电路。当结点温度上升到135°C (典型值) 时，热敏关闭电路变为检测状态，切换工作被停止。当结点温度下降到115°C (典型值) 时，热敏关闭电路变为解除状态，切换工作重新开始。  
由于IC的自身发热而导致热敏关闭电路变为检测状态时，切换工作会被停止，输出电压 (V<sub>OUT</sub>) 也随之下降。因此，IC的自身发热受限制后，温度也随之降低。IC的温度降低后，热敏关闭电路变为解除状态，切换工作重新开始，随后，IC再一次发生自身发热的现象。这种工作现象反复发生后，会使V<sub>OUT</sub>的波形变为脉冲状。要阻止这种现象，只有将EN端子设为 "L"，降低输出电流 (I<sub>OUT</sub>)，促使内部消耗功率变少，或者通过降低周围环境温度来停止切换工作的停止或启动。

表9

热敏关闭电路	V <sub>OUT</sub> 端子电压
解除 : 115°C (典型值) <sup>*1</sup>	V <sub>OUT</sub>
检测 : 135°C (典型值) <sup>*1</sup>	"High-Z"

\*1. 结点温度

### 1.7 过载电流保护功能

S-85S0P系列内置了过载电流保护电路。过载电流保护电路的目的是为了防止IC因过负载以及电感器的磁性饱和等而受到热破坏，通过监视流入低侧端功率MOS FET的电流来进行过载电流保护。

当低侧端功率MOS FET流入限制电流 (I<sub>LIM</sub>) 以上的电流时，过载电流保护电路开始工作，直到低于低侧端电流限制值 (I<sub>LIMDET</sub>) 为止，禁止设置高侧端功率MOS FET为ON。当低侧端功率MOS FET流入的电流值降低到I<sub>LIMDET</sub>以下时，S-85S0P系列恢复为通常工作。I<sub>LIMDET</sub>在IC内部固定为120 mA (典型值)，I<sub>LIM</sub>因所使用的外接元器件的不同而异。I<sub>LIM</sub>、电感器的值 (L)、输入力电压 (V<sub>IN</sub>)、输出电压 (V<sub>OUT</sub>) 的关系如下式所示。

$$I_{LIM} = I_{LIMDET} + \frac{1}{2 \times L \times f_{SW}} \times \frac{(V_{IN} - V_{OUT}) \times V_{OUT}}{V_{IN}}$$

### 1.8 自动复归型短路保护功能 (Hiccup控制)

S-85S0P系列内置了Hiccup控制的自动复归型短路保护功能。

Hiccup控制是当IC检测到过载电流而停止切换工作后，定期地尝试自动复归的方式。

#### 1.8.1 过负载状态被解除时

- <1> 检测过载电流
- <2> 低电压检测电路 (UVP电路) 检测出输出电压 ( $V_{OUT}$ ) 的降低
- <3> 经过220  $\mu$ s
- <4> 停止切换工作 (9 ms (典型值) 期间)
- <5> 负载状态被解除
- <6> IC重新启动，软启动功能开始工作  
此时，不需要从外部输入为了进行重新启动的复位信号
- <7> 经过1.0 ms (典型值) 后， $V_{OUT}$ 达到 $V_{OUT(S)}$

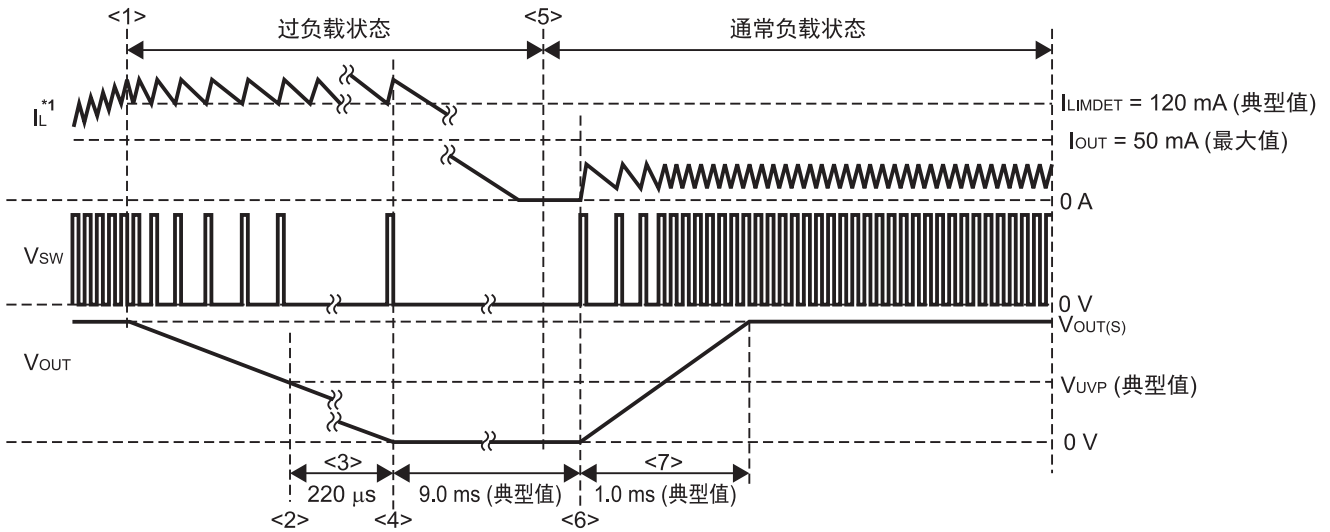


图4

#### 1.8.2 过负载状态持续时

- <1> 检测过载电流
- <2> UVP电路检测出 $V_{OUT}$ 的降低
- <3> 经过220  $\mu$ s
- <4> 停止切换工作 (9 ms (典型值) 期间)
- <5> IC重新启动，软启动功能开始工作
- <6> 经过1.25 ms (典型值) 后，过负载状态持续时重复<2>以后的工作

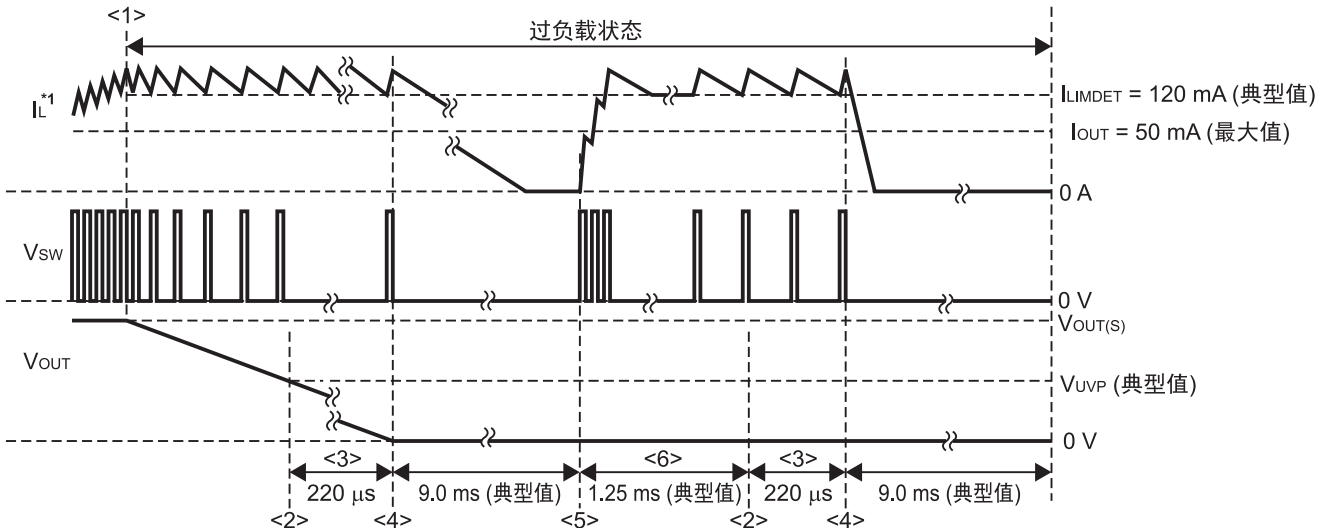


图5

### 1.9 预偏压的软启动功能

S-85S0P系列内置了预偏压的软启动电路。

通过重新启动电源，使输出电压 ( $V_{OUT}$ ) 在残留有电荷的状态下，或在事先已被偏压的状态 (预置偏压状态) 下启动预偏压的软启动电路时，在软启动电压不超过内部反馈电压期间，切换工作停止，可保持 $V_{OUT}$ 不变。若软启动电压超过了内部反馈电压，切换工作重新开始， $V_{OUT}$ 会上升到输出电压设定值 ( $V_{OUT(S)}$ )。因此，被预偏压的 $V_{OUT}$ 不会降低而达到 $V_{OUT(S)}$ 。

没有预偏压的软启动电路在切换工作开始时，通过放电低侧端功率MOS FET的残留电荷，有可能流入大电流而导致IC被破坏。有预偏压的软启动电路在切换工作开始时，可以避免大电流来保护IC，并且容易进行应用电路的电源设计。

S-85S0P系列可通过软启动电路使 $V_{OUT}$ 缓慢上升到 $V_{OUT(S)}$ 。

以下的情况，可抑制冲击电流以及 $V_{OUT}$ 的过冲。

- 接通电源时
- EN端子从 "L" 变为 "H" 时
- UVLO工作解除时
- 热敏关闭工作解除时
- 短路复归时

另外，在以下的条件下软启动电路开始工作。

对EN端子输入 "H"，在经过软启动等待时间 ( $t_{SSW}$ ) = 1.5 ms (典型值) 后，软启动电路开始工作。软启动时间 ( $t_{SS}$ ) 设定为1.0 ms (典型值)。

- 重新接通电源 (IC重新启动) 时
- UVLO检测时 (UVLO解除后)
- 热敏关闭检测时 (热敏关闭解除后)
- Hiccup控制后

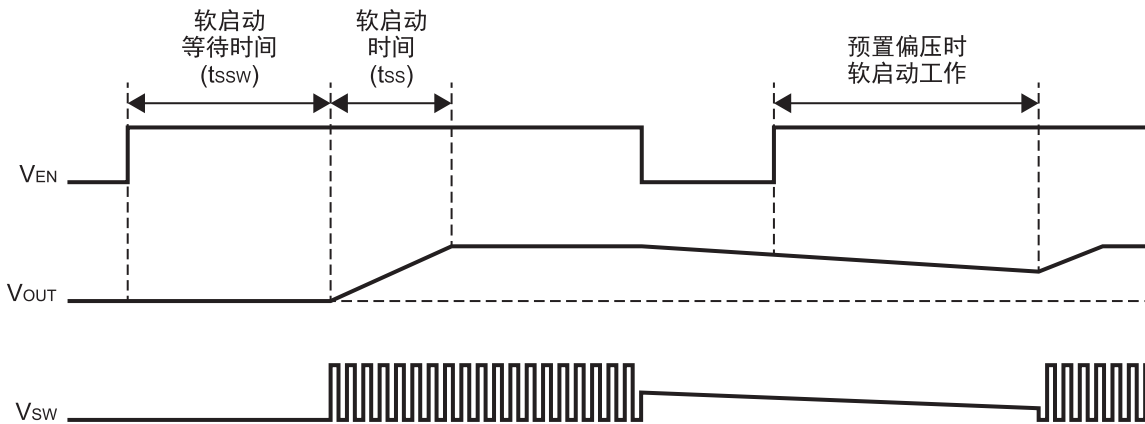


图6

## 2. 电源分压部分

电源分压输出功能是指把DC-DC转换器的输入电压 ( $V_{IN}$ ) 分压为 $V_{IN}/2$ 或 $V_{IN}/3$ ，然后输出此电压的功能。例如，通过将输出电压 ( $V_{PMOUT}$ ) 输入到微机的A/D转换器，微机即可监视电池电压。把IC与微机连接，即可作为锂离子可充电电池、硬币型电池等的电池余量监视器来使用。

S-85S0PCxx将 $V_{IN}$ 分压为 $V_{IN}/2$ ，S-85S0PDxx将 $V_{IN}$ 分压为 $V_{IN}/3$ 。

由于电源分压部分的缓冲放大器可构成电压跟随器，因此可实现低输出阻抗。

电源分压部分和DC-DC转换器部分各自独立的进行工作。在PMEN端子为"L"，电源分压部分处于待机状态时，通过2.8 k $\Omega$ 左右的阻抗，连接在PMOUT端子的输出电容器的电荷被放电。

### 2.1 基本工作

图7所示为电源分压部分的基本工作说明的框图。

利用分压电阻 ( $R_{pm1}$ 和 $R_{pm2}$ ) 将 $V_{IN}$ 分压为 $V_{IN}/2$ 或 $V_{IN}/3$ ，可获得基准电压 ( $V_{refpm}$ )。由于电压跟随器中包括有缓冲放大器，可进行反馈控制，使 $V_{PMOUT}$ 和 $V_{refpm}$ 相同。利用缓冲放大器，在输出与 $V_{IN}$ 相应的 $V_{PMOUT}$ 的同时，实现了低输出阻抗。

PMEN端子输入"L"，可以停止 $R_{pm1}$ 与 $R_{pm2}$ 中的电流和缓冲放大器的电流。缓冲放大器的输出因内置的N沟道晶体管而下拉至 $V_{SS}$ ， $V_{PMOUT}$ 会变为 $V_{SS}$ 电位。

实际的 $V_{PMOUT}$ 和 $V_{PMOUT(S)}$ 会产生输出失调电压 ( $V_{POF}$ ) 份额的差异，变为 $V_{PMOUT} = V_{PMOUT(S)} + V_{POF}$ 。

另外， $V_{PMOUT}$ 因负载电流会发生微弱的变化，变化值表示为输出阻抗 ( $R_{PS}$ )。

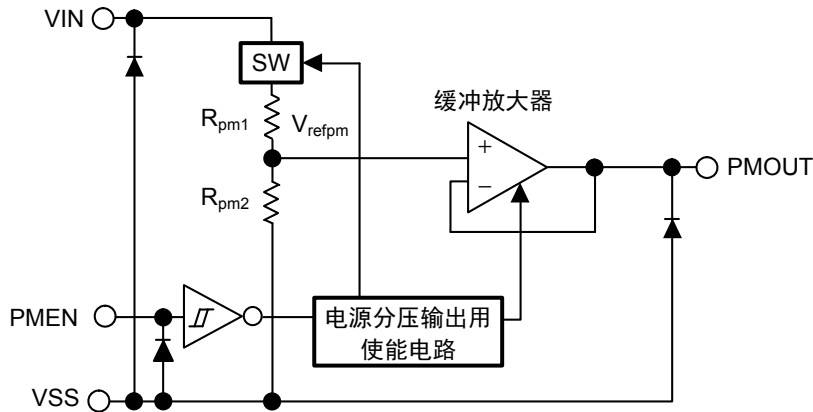


图7

## 2.2 PMEN端子

PMEN端子可控制电源分压输出用使能电路。

对PMEN端子输入 "H"，电源分压输出用使能电路开始工作。因此，电源分压输出功能变为有效，可以进行电源电压的监视。对PMEN端子输入 "L"，电源分压输出用使能电路停止工作。因此，电源分压输出功能变为无效，可以控制IC的消耗电流。另外，PMEN端子不会对DC-DC控制器部分的工作产生任何影响。

表10

PMEN 端子	电源分压输出功能	输出电压 ( $V_{PMOUT}$ )
"H"	有效 (通常工作)	$V_{PMOUT}^{*1}$
"L"	无效 (待机)	$V_{SS}$ 电位

\*1. 请参阅 "■ 电气特性"、表7的\*1。

PMEN端子的内部等效电路如图8所示，PMEN端子既不被上拉也不被下拉。因此，请不要在悬空状态下使用。不使用PMEN端子时，请与VIN端子连接。另外，如果在PMEN端子上施加 $0.25\text{ V} \sim V_{IN} - 0.3\text{ V}$ 的电压，则消耗电流会增加，务请注意。

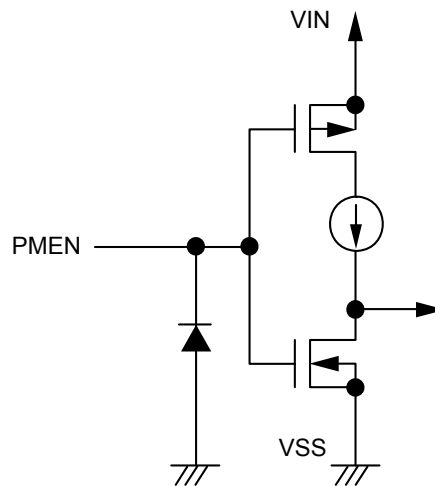


图8

### 2.3 PMEN端子电压和输出电压 ( $V_{PMOUT}$ )

PMEN端子电压和电源分压输出功能的关系如图9所示。

对PMEN端子输入 "H", 电源分压输出功能变为有效。在上电时间 ( $t_{PU}$ ) = 10 ms (最大值)<sup>\*1</sup> 结束后, 输出电压 ( $V_{PMOUT}$ ) 变得稳定, 可进行电源电压的监视。

对PMEN端子输入 "L", 电源分压输出功能变为无效。因内置的N沟道晶体管,  $V_{PMOUT}$ 变为 $V_{SS}$ 电位。通过反复向PMEN端子输入 "H" 和 "L", 可降低不进行电源电压监视期间的消耗电流。

\*1.  $T_a = +25^\circ\text{C}$ ,  $V_{IN} = 3.6\text{ V}$ ,  $C_{PM} = 0.22\ \mu\text{F}$ , 无负载的情况下

动态 "H"

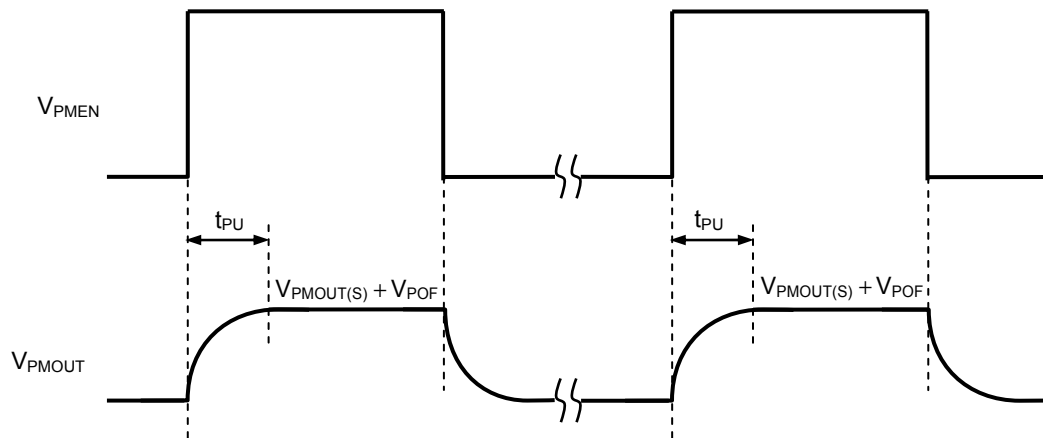


图9

备注  $V_{PMEN} = V_{IN} \leftrightarrow V_{SS}$

## ■ 典型应用

图10所示为S-85S0P系列的典型应用电路图，图11所示为时序图。

如图10所示，将PMOUT端子与微机的A/D转换器的模拟输入端子 (AIN端子) 连接后，将输出电压 ( $V_{PMOUT}$ ) 输入到A/D转换器，微机便可监视电池电压。

来自电池的输入电压通过切换工作变为输出电压，微机利用此电压驱动。通过将I/O端子输出的 "H"、"L" 信号输入到PMEN端子，微机可以控制电源分压输出功能。请根据微机A/D转换器的工作时序来控制电源分压输出功能。

对PMEN端子输入 "H"，微机可进行电池电压的监视。在不进行电池电压监视期间，可对PMEN端子输入 "L"，以降低IC的消耗电流。

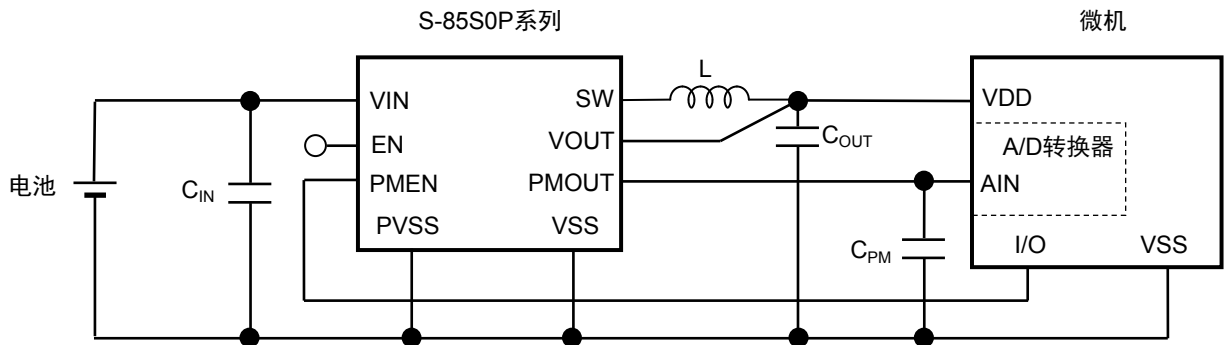


图10

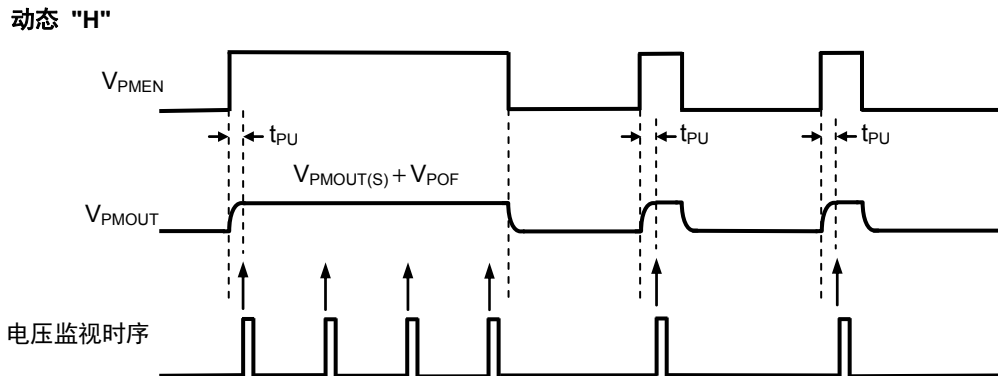


图11



■ 标准电路

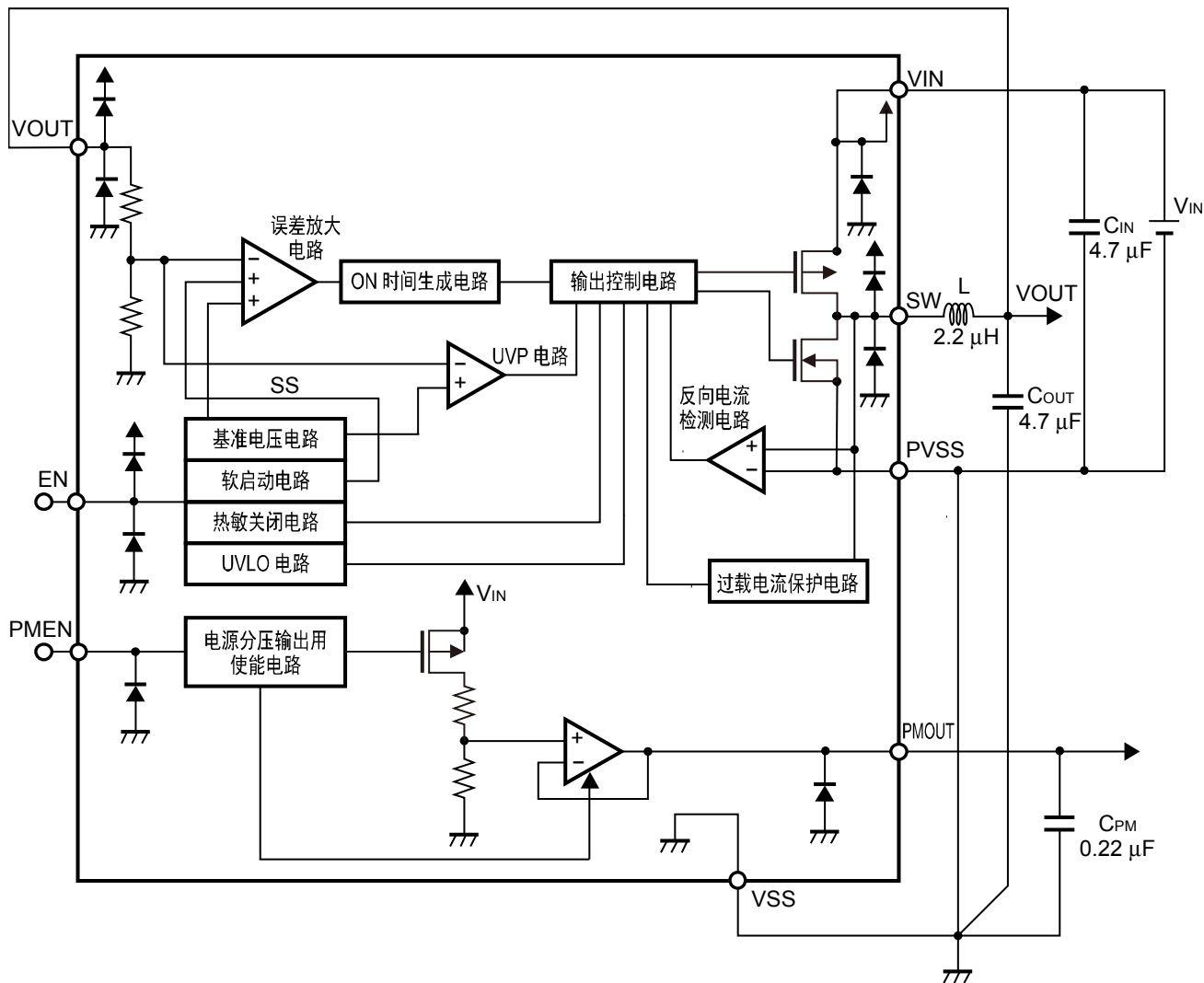


图12

注意 上述连接图以及参数仅供参考，并不作为保证工作的依据。请在进行充分的评价基础上，设定实际应用电路的参数。

## ■ 外接元器件的选定

各个外接元器件的可以选择的值和推荐值如表11所示。  
C<sub>IN</sub>、C<sub>OUT</sub>请使用陶瓷电容器。

表11

项目	输入电容器 (C <sub>IN</sub> )	输出电容器 (C <sub>OUT</sub> )	电感器 (L)	电源分压部分输出电容器 (C <sub>PM</sub> )
可以选择的值	大于或等于2.2 μF	4.7 μF ~ 100 μF	1.5 μH ~ 10 μH	0.10 μF ~ 0.22 μF
推荐值	4.7 μF	4.7 μF	2.2 μH	-

### 1. DC-DC转换器部分输入电容器 (C<sub>IN</sub>)

C<sub>IN</sub>可以降低电源阻抗、使输入电流平均化、提高效率和改善耐噪声特性。请根据使用的电源阻抗来选定电容器。另外，请考虑使用的电容器的DC偏压特性。

### 2. DC-DC转换器部分输出电容器 (C<sub>OUT</sub>)

C<sub>OUT</sub>是为了平滑输出电压而使用的。容量值越大，越能改善负载变动时的过冲、下冲、输出纹波电压。请在实际的使用状态下进行充分的评价之后，再选定最佳的电容器。

表12 推荐电容器 (C<sub>IN</sub>、C<sub>OUT</sub>) 一览 (V<sub>OUT(S)</sub> ≤ 2.5 V时)

厂家	型号	电容量	耐压	尺寸 (L × W × H)
Murata Manufacturing Co., Ltd.	GRM035R60J475ME15	4.7 μF	6.3 V	0.6 mm × 0.3 mm × 0.5 mm
Murata Manufacturing Co., Ltd.	GRJ155R61A106ME12	10 μF	10 V	1.0 mm × 0.5 mm × 0.5 mm

表13 推荐电容器 (C<sub>IN</sub>、C<sub>OUT</sub>) 一览 (V<sub>OUT(S)</sub> > 2.5 V时)

厂家	型号	电容量	耐压	尺寸 (L × W × H)
Murata Manufacturing Co., Ltd.	GRJ155R61A106ME12	10 μF	10 V	1.0 mm × 0.5 mm × 0.5 mm

### 3. DC-DC转换器部分电感器 (L)

在选用电感器 (L) 时，请注意电感器的容许电流。超过此容许值的电流流入电感器会引起电感器处于磁气饱和状态，明显地降低工作效率，也有可能引发因大电流而导致IC被破坏。

因此，请选用包括过载电流检测时的峰值电流值 (I<sub>PK</sub>) 在内的不超过此容许电流的电感器。

如需注重负载响应特性时，请选择2.2 μH等电感值较小的电感器。注重效率时，请选择4.7 μH等电感值较大的电感器。I<sub>PK</sub>可使用以下的公式算出。

$$I_{PK} = I_{OUT} + \frac{1}{2 \times L \times f_{SW}} \times \frac{(V_{IN} - V_{OUT}) \times V_{OUT}}{V_{IN}}$$

表14 推荐电感器 (L) 一览 (V<sub>IN</sub> ≤ 4.2 V时)

厂家	型号	电感值	额定电流	尺寸 (L × W × H)
TAIYO YUDEN CO.,LTD.	MBKK1608T2R2M	2.2 μH	520 mA	1.6 mm × 0.8 mm × 1.0 mm
Murata Manufacturing Co., Ltd.	DFE201210S-2R2M=P2	2.2 μH	2000 mA	2.0 mm × 1.2 mm × 1.0 mm
Würth Elektronik GmbH & Co. KG	74438313022	2.2 μH	850 mA	1.6 mm × 1.6 mm × 1.0 mm
TDK Corporation	MLP2012S2R2MT0S1	2.2 μH	800 mA	2.0 mm × 1.25 mm × 0.85 mm

表15 推荐电感器 (L) 一览 (V<sub>IN</sub> > 4.2 V时)

厂家	型号	电感值	额定电流	尺寸 (L × W × H)
Murata Manufacturing Co., Ltd.	DFE201210S-2R2M=P2	2.2 μH	2000 mA	2.0 mm × 1.2 mm × 1.0 mm
Würth Elektronik GmbH & Co. KG	74438313022	2.2 μH	850 mA	1.6 mm × 1.6 mm × 1.0 mm
TDK Corporation	MLP2012S2R2MT0S1	2.2 μH	800 mA	2.0 mm × 1.25 mm × 0.85 mm

#### 4. 电源分压部分输出电容器 (C<sub>PM</sub>)

在选用C<sub>PM</sub>时, 请考虑工作稳定性。电容量较大时, V<sub>PMOUT</sub>达到所期待的电压为止的上升时间 (上电时间 (t<sub>PU</sub>)) 也变长。

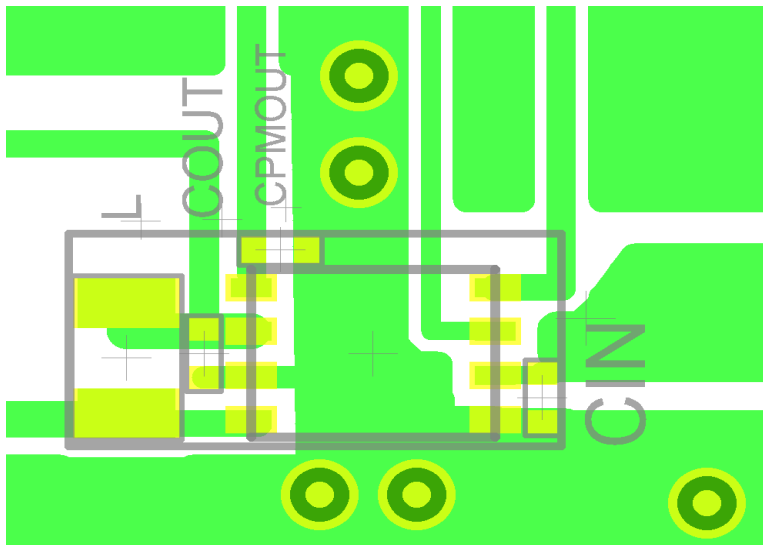
表16 推荐电容器 (C<sub>PM</sub>) 一览

厂家	型号	电容量	耐压	尺寸 (L×W×H)
TDK Corporation	CGA2B2X5R1A104M050BA	0.10 μF	6.3 V	1.0 mm × 0.5 mm × 0.5 mm
TDK Corporation	C0603X5R0J224M030BB	0.22 μF	6.3 V	0.6 mm × 0.3 mm × 0.3 mm
Murata Manufacturing Co., Ltd.	GRM033R60J104ME19	0.10 μF	6.3 V	0.6 mm × 0.3 mm × 0.3 mm
Murata Manufacturing Co., Ltd.	GRM033R60J224ME90	0.22 μF	6.3 V	0.6 mm × 0.3 mm × 0.3 mm

## ■ 基板布局指南

进行S-85S0P系列的基板布局时，请注意如下的注意事项。

- 请尽量将C<sub>IN</sub>配置在VIN端子和PVSS端子的附近。
- 请尽量将VIN格式和GND格式设置得更宽。
- 为了能充分散热，请对GND格式配置散热孔。
- 请在从电容器的端子远离3 mm ~ 4 mm左右的位置，配置C<sub>IN</sub>以及C<sub>OUT</sub>附近的散热孔。
- SW端子中会流入较大的电流。为了使寄生电容量和放射噪声最小化，请缩小连接SW端子的格式的布线面积。
- 请不要在IC的下方进行SW端子的格式布线。



总计尺寸 : 5.0 mm × 2.2 mm = 11.0 mm<sup>2</sup>

图13 参考基板格式

**注意** 上述格式图仅供参考，并不作为保证工作的依据。请在进行充分的评价基础上，再决定实际应用电路的格式。

**备注** 请参阅SNT-8A的焊盘图以及 "SNT封装的应用指南"。

## ■ 注意事项

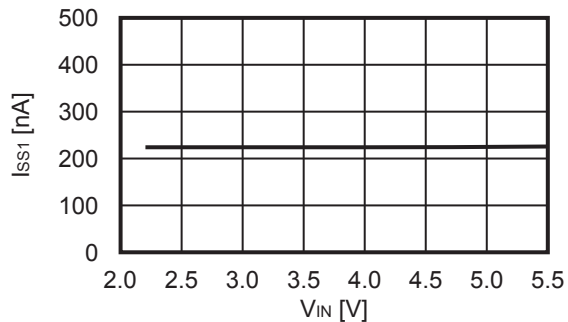
- 外接的电容器、电感器等请尽量安装在IC附近，并进行单点接地。
- 包含了DC-DC控制器的IC，会产生特有的纹波电压和尖峰噪声。另外，在电源投入时会流入冲击电流。这些现象会因所使用的线圈、电容器以及电源阻抗的不同而受到很大的影响。因此，设计时请在实际的应用电路上进行充分的评价。
- VIN端子 - VSS端子间所连接的电容为4.7  $\mu$ F的电容器为旁路电容器。针对使用在高负载条件下的应用电路，由于备有使IC内部的电源稳定工作的功能，因此可有效地实现切换工作的稳定。请优先地将旁路电容器安装在IC附近。
- 本IC虽内置防静电保护电路，但请不要对IC施加超过保护电路性能的过大静电。
- 本IC的容许功耗因安装基板的尺寸、材料等的不同而产生很大的变动。设计时请在实际的应用电路上进行充分的评价。
- 使用本公司的IC生产产品时，如在其产品中对该IC的使用方法或产品的规格，或因与所进口国对包括本IC产品在内的制品发生专利纠纷时，本公司概不承担相应责任。

■ 各种特性数据 (典型数据)

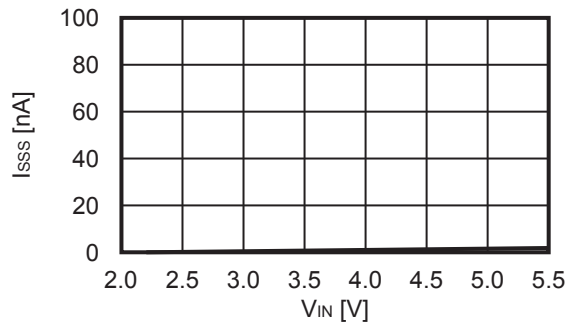
1. 主要项目依靠电源特性示例 (Ta = +25°C)

DC-DC转换器部分

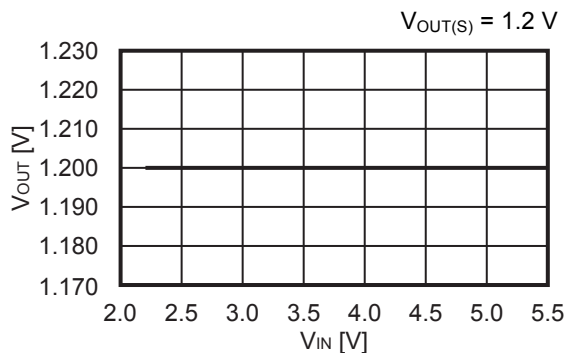
1.1 静止时消耗电流 (I<sub>SS1</sub>) – 输入电压 (V<sub>IN</sub>)



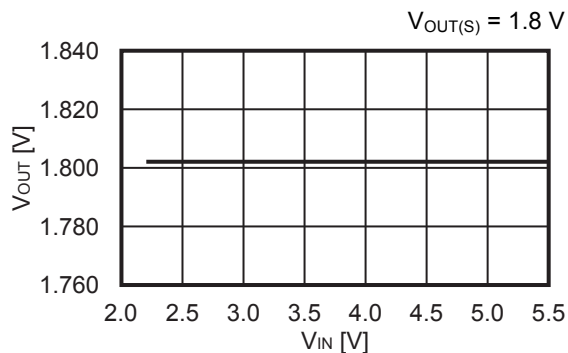
1.2 休眠时消耗电流 (I<sub>SSS</sub>) – 输入电压 (V<sub>IN</sub>)



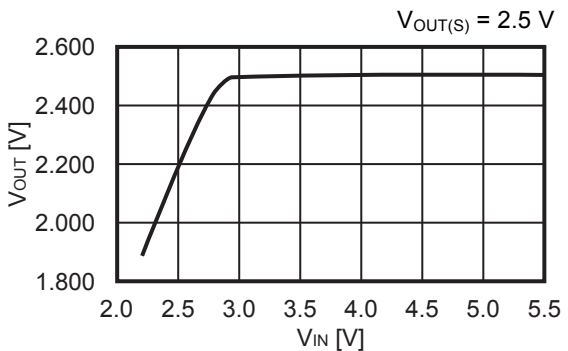
1.3 输出电压 (V<sub>OUT</sub>) – 输入电压 (V<sub>IN</sub>)



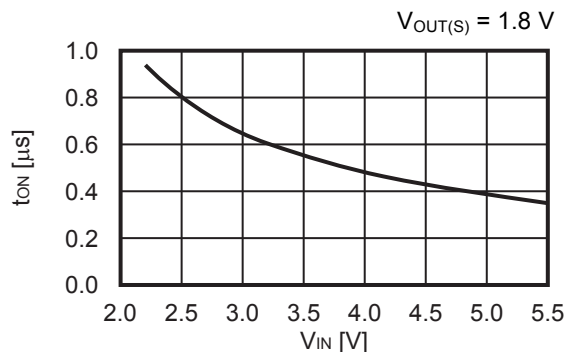
1.4 输出电压 (V<sub>OUT</sub>) – 输入电压 (V<sub>IN</sub>)



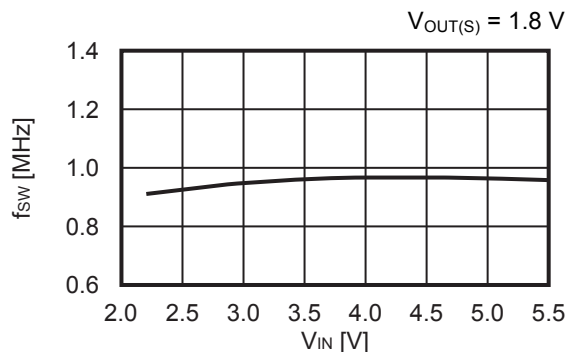
1.5 输出电压 (V<sub>OUT</sub>) – 输入电压 (V<sub>IN</sub>)



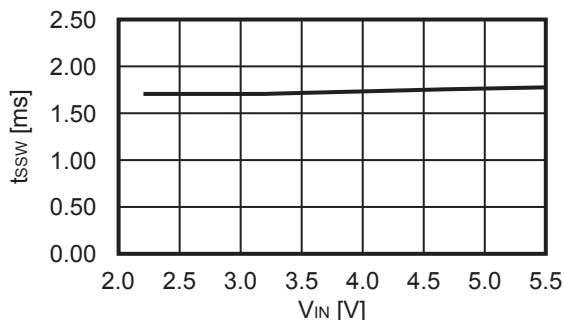
1.6 ON时间 (t<sub>ON</sub>) – 输入电压 (V<sub>IN</sub>)



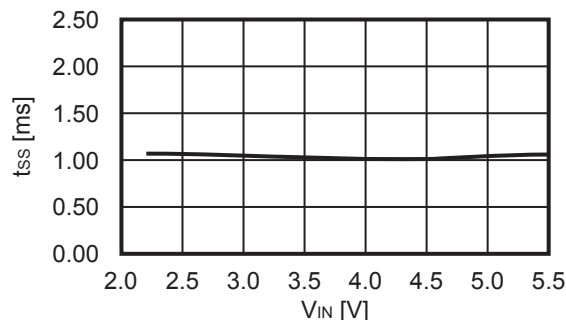
1.7 切换频率 (f<sub>sw</sub>) – 输入电压 (V<sub>IN</sub>)



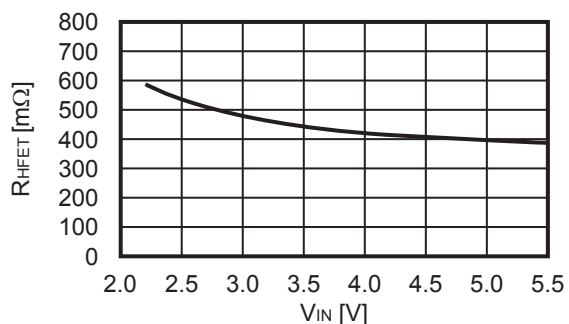
1.8 软启动等待时间 ( $t_{SSW}$ ) – 输入电压 ( $V_{IN}$ )



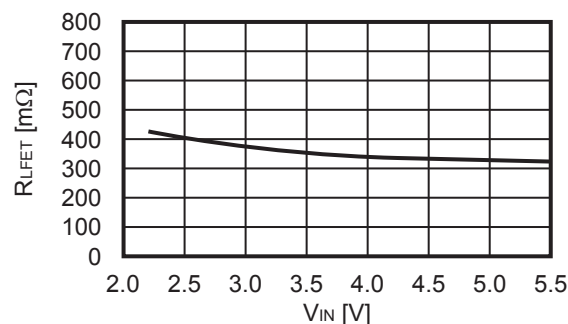
1.9 软启动时间 ( $t_{SS}$ ) – 输入电压 ( $V_{IN}$ )



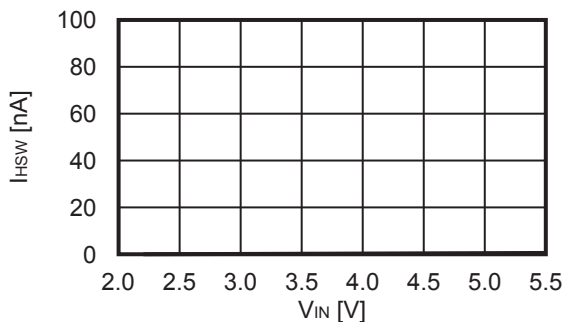
1.10 高侧端功率MOS FET导通电阻 ( $R_{HFET}$ ) – 输入电压 ( $V_{IN}$ )



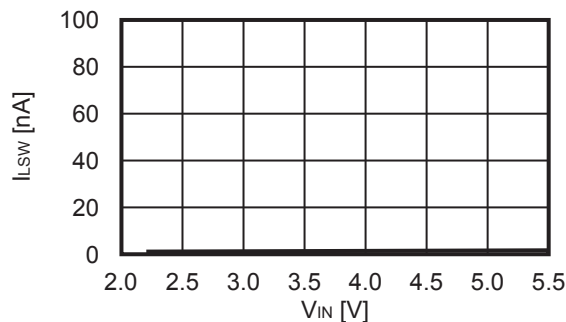
1.11 低侧端功率MOS FET导通电阻 ( $R_{LFET}$ ) – 输入电压 ( $V_{IN}$ )



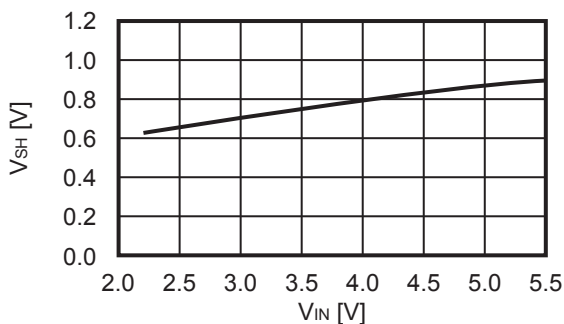
1.12 高侧端功率MOS FET泄漏电流 ( $I_{HSW}$ ) – 输入电压 ( $V_{IN}$ )



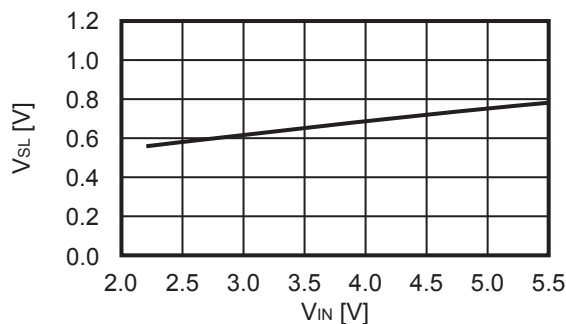
1.13 低侧端功率MOS FET泄漏电流 ( $I_{LSW}$ ) – 输入电压 ( $V_{IN}$ )



1.14 高电位输入电压 ( $V_{SH}$ ) – 输入电压 ( $V_{IN}$ )



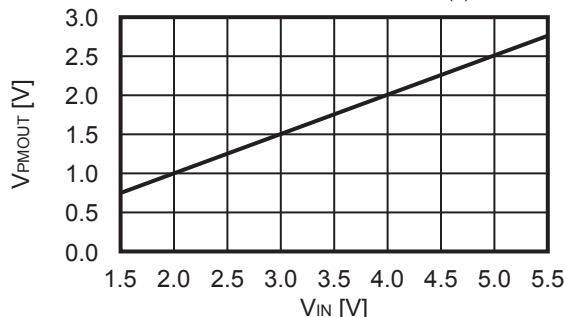
1.15 低电位输入电压 ( $V_{SL}$ ) – 输入电压 ( $V_{IN}$ )



电源分压部分

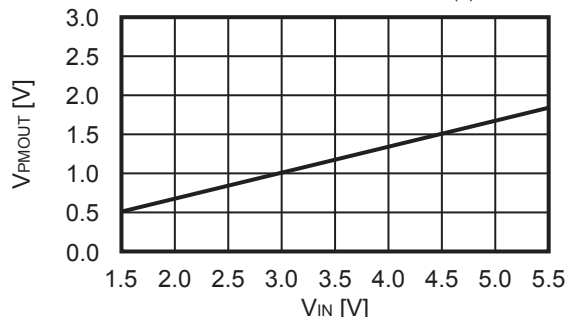
1.16 输出电压 ( $V_{PMOUT}$ ) – 输入电压 ( $V_{IN}$ )

$$V_{PMOUT(S)} = V_{IN}/2$$

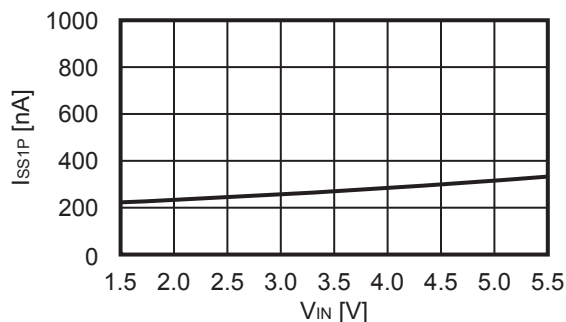


1.17 输出电压 ( $V_{PMOUT}$ ) – 输入电压 ( $V_{IN}$ )

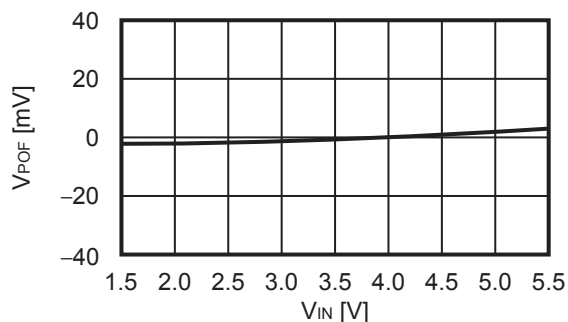
$$V_{PMOUT(S)} = V_{IN}/3$$



1.18 工作时消耗电流 ( $I_{SS1P}$ ) – 输入电压 ( $V_{IN}$ )

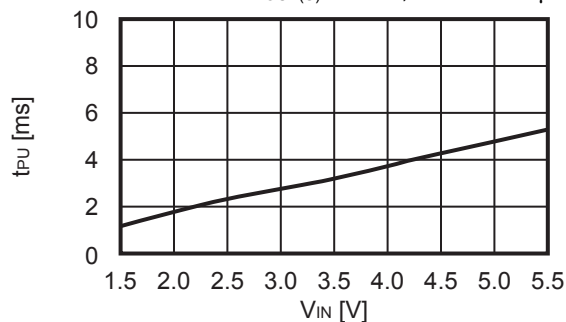


1.19 输出补偿电压 ( $V_{POF}$ ) – 输入电压 ( $V_{IN}$ )



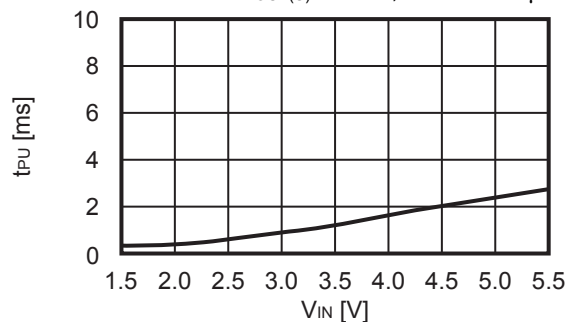
1.20 上电时间 ( $t_{PU}$ ) – 输入电压 ( $V_{IN}$ )

$$V_{PMOUT(S)} = V_{IN}/2, C_{PM} = 0.22 \mu F$$

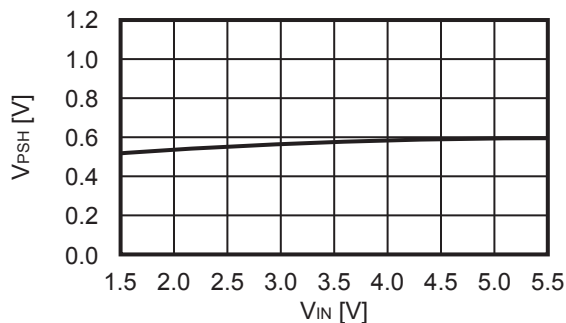


1.21 上电时间 ( $t_{PU}$ ) – 输入电压 ( $V_{IN}$ )

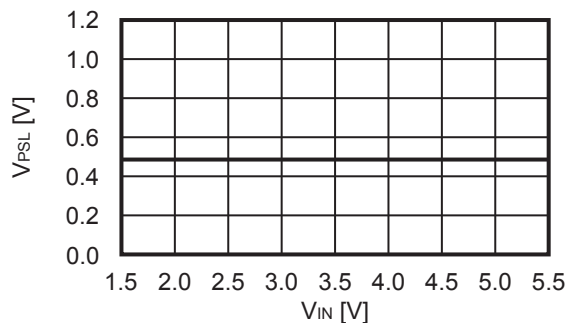
$$V_{PMOUT(S)} = V_{IN}/3, C_{PM} = 0.22 \mu F$$



1.22 PMEN端子输入电压 "H" ( $V_{PSH}$ ) – 输入电压 ( $V_{IN}$ )



1.23 PMEN端子输入电压 "L" ( $V_{PSL}$ ) – 输入电压 ( $V_{IN}$ )

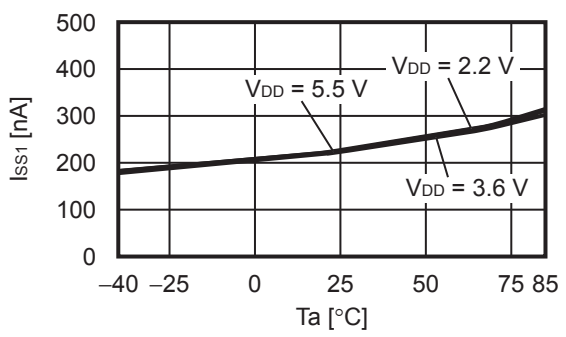




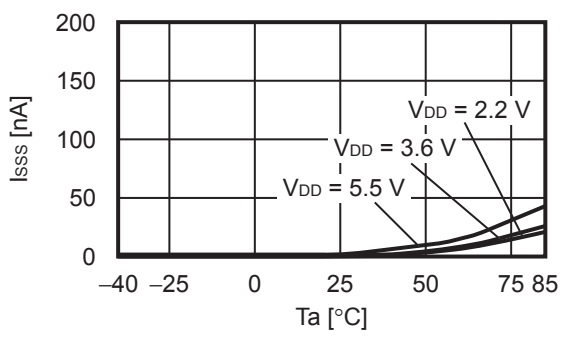
2. 主要项目温度特性例 (Ta = -40°C ~ +85°C)

DC-DC转换器部分

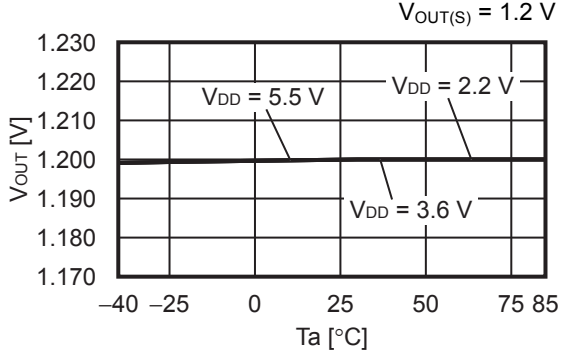
2.1 静止时消耗电流 (I<sub>SS1</sub>) - 温度 (Ta)



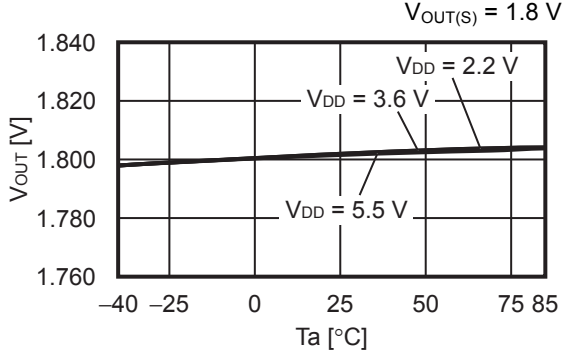
2.2 休眠时消耗电流 (I<sub>SSS</sub>) - 温度 (Ta)



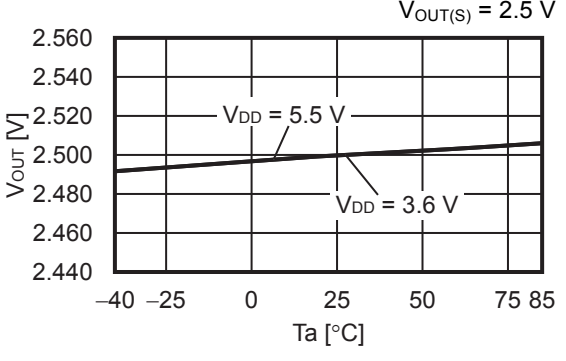
2.3 输出电压 (V<sub>OUT</sub>) - 温度 (Ta)



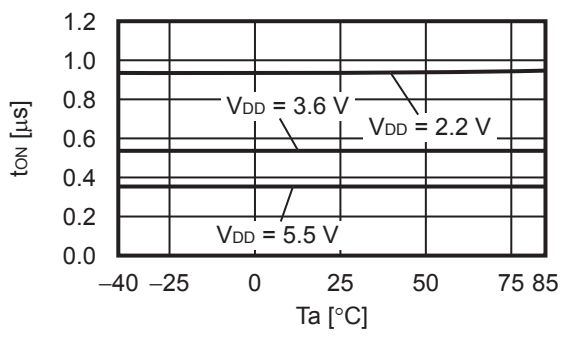
2.4 输出电压 (V<sub>OUT</sub>) - 温度 (Ta)



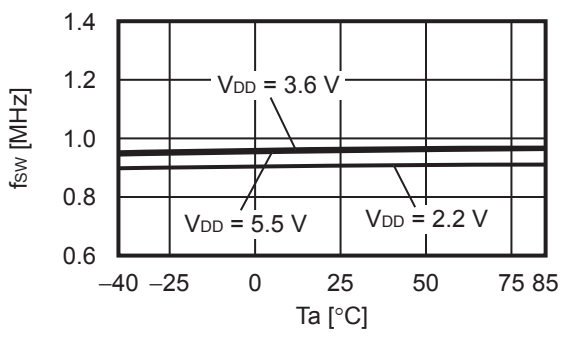
2.5 输出电压 (V<sub>OUT</sub>) - 温度 (Ta)



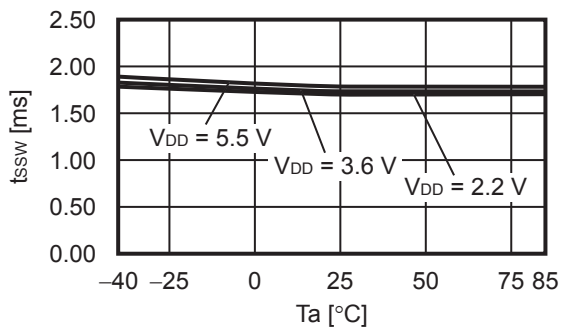
2.6 ON时间 (t<sub>ON</sub>) - 温度 (Ta)



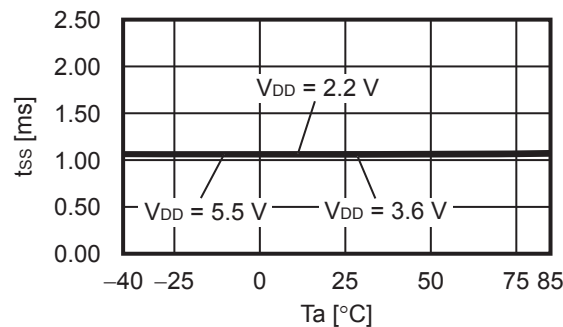
2.7 切换频率 (f<sub>sw</sub>) - 温度 (Ta)



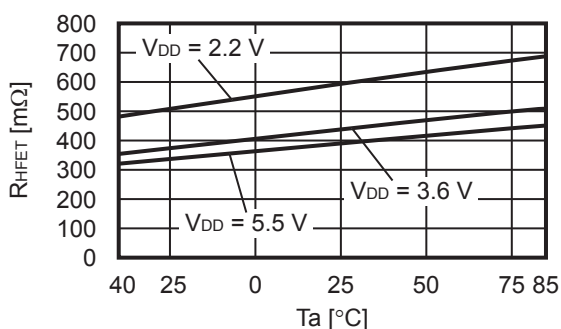
2.8 软启动等待时间 ( $t_{SSW}$ ) – 温度 ( $T_a$ )



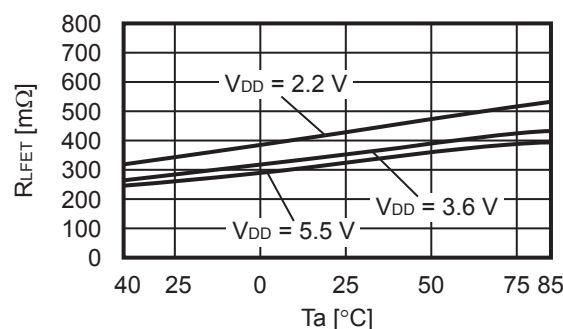
2.9 软启动时间 ( $t_{SS}$ ) – 温度 ( $T_a$ )



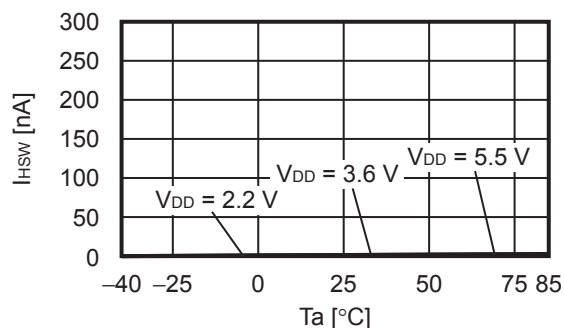
2.10 高侧端功率MOS FET导通电阻 ( $R_{HFET}$ ) – 温度 ( $T_a$ )



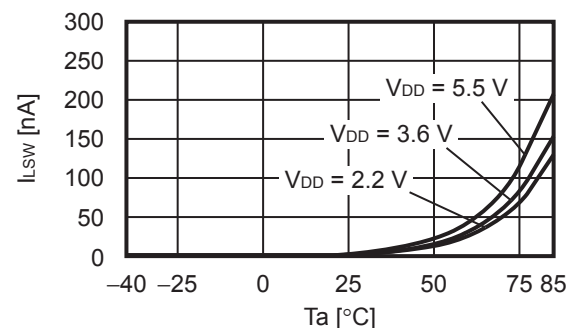
2.11 低侧端功率MOS FET导通电阻 ( $R_{LFET}$ ) – 温度 ( $T_a$ )



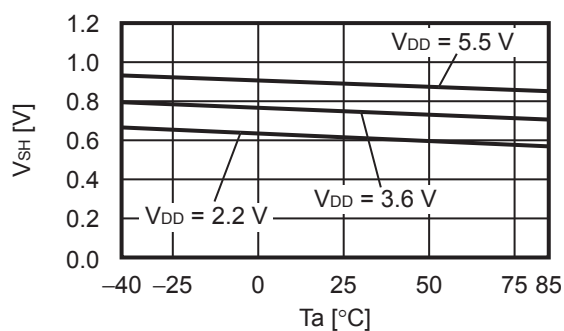
2.12 高侧端功率MOS FET泄漏电流 ( $I_{HSW}$ ) – 温度 ( $T_a$ )



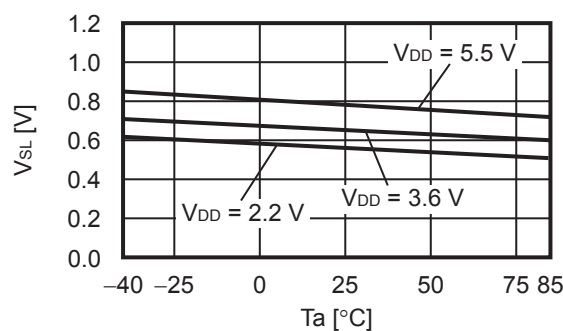
2.13 低侧端功率MOS FET泄漏电流 ( $I_{LSW}$ ) – 温度 ( $T_a$ )



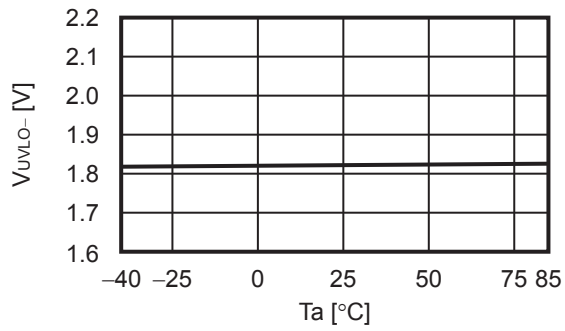
2.14 高电位输入电压 ( $V_{SH}$ ) – 温度 ( $T_a$ )



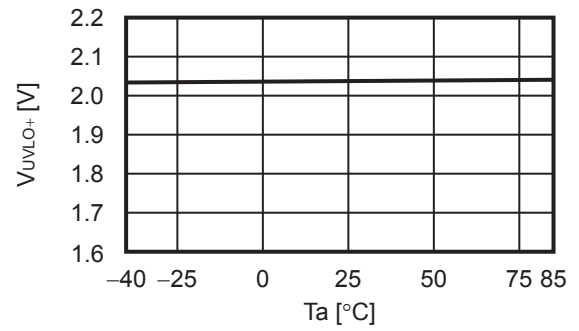
2.15 低电位输入电压 ( $V_{SL}$ ) – 温度 ( $T_a$ )



2.16 UVLO检测电压 ( $V_{UVLO-}$ ) – 温度 ( $T_a$ )

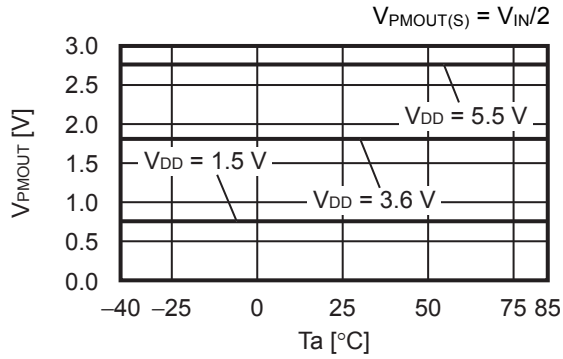


2.17 UVLO解除电压 ( $V_{UVLO+}$ ) – 温度 ( $T_a$ )

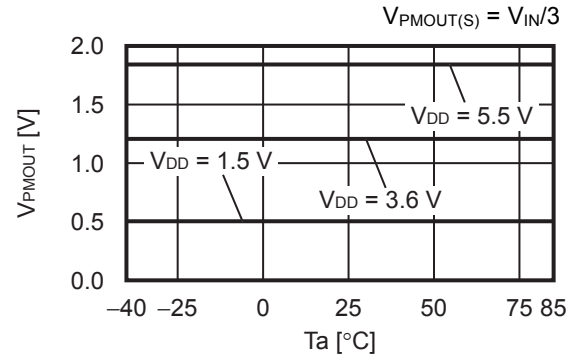


电源分压部分

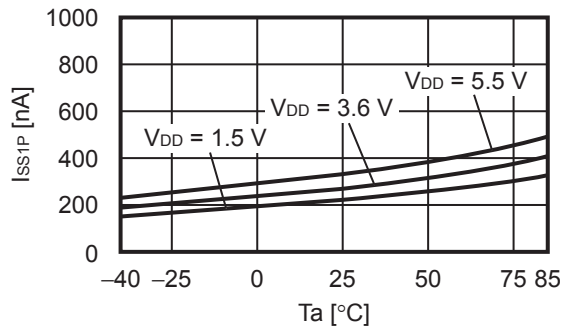
2.18 输出电压 ( $V_{PMOUT}$ ) – 温度 ( $T_a$ )



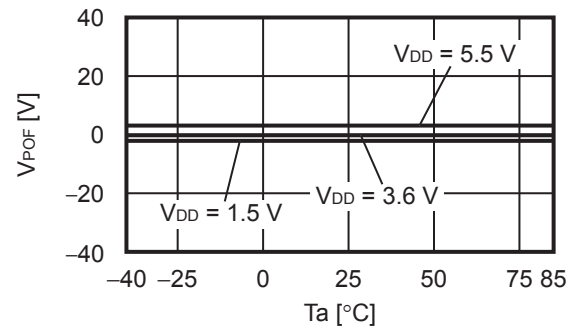
2.19 输出电压 ( $V_{PMOUT}$ ) – 温度 ( $T_a$ )



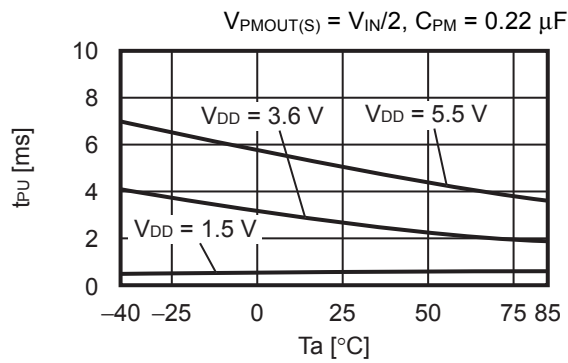
2.20 工作时消耗电流 ( $I_{SS1P}$ ) – 温度 ( $T_a$ )



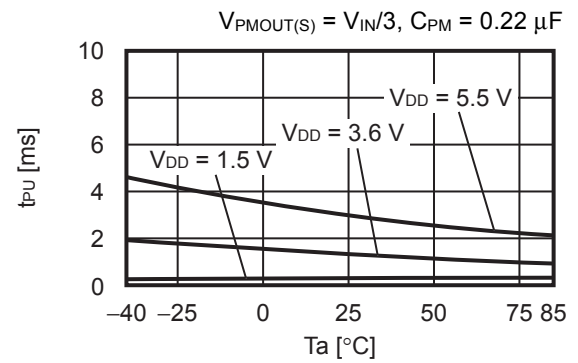
2.21 输出补偿电压 ( $V_{POF}$ ) – 温度 ( $T_a$ )



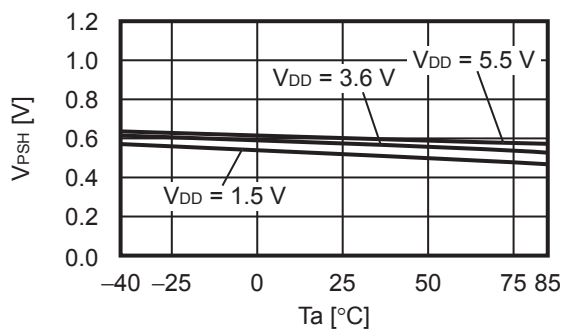
2.22 上电时间 ( $t_{PU}$ ) – 温度 ( $T_a$ )



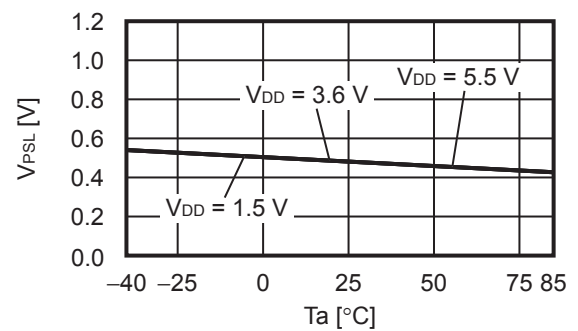
2.23 上电时间 ( $t_{PU}$ ) – 温度 ( $T_a$ )



2.24 PMEN端子输入电压 ( $V_{PSH}$ ) – 温度 ( $T_a$ )



2.25 PMEN端子输入电压 ( $V_{PSL}$ ) – 温度 ( $T_a$ )



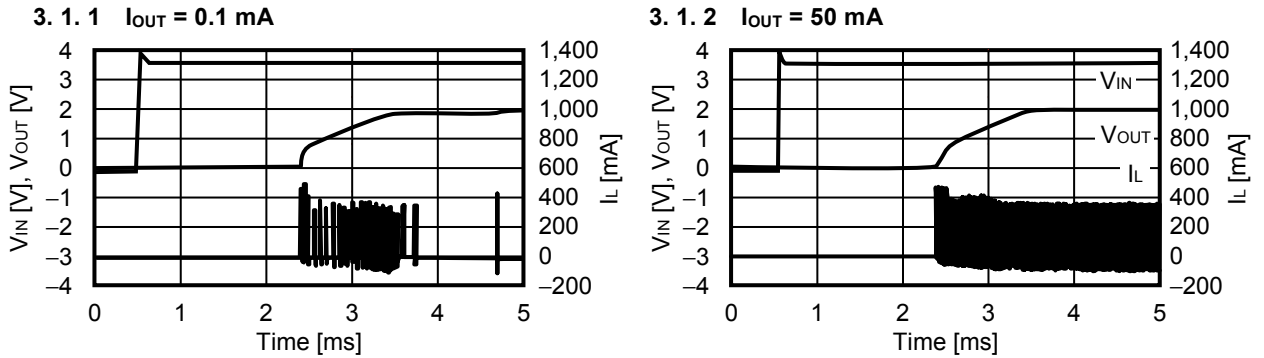
### 3. 过渡响应特性示例

在 "3. 过渡响应特性示例" 中, 使用了如表17所示的外接元器件。

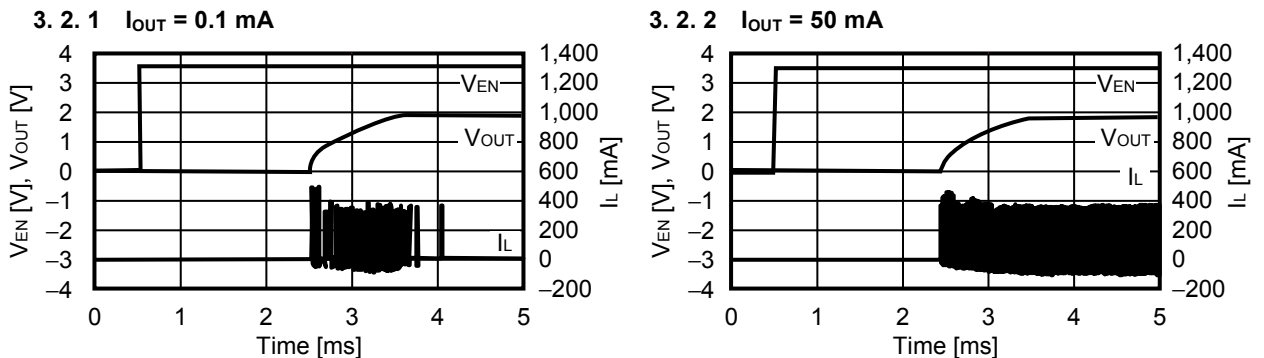
表17

元器件	参数	厂家	型号
电感器	2.2 $\mu$ H	Murata Manufacturing Co., Ltd.	DFE201210S-2R2M=P2
输入电容器	10 $\mu$ F	Murata Manufacturing Co., Ltd.	GRJ155R61A106ME12
输出电容器	10 $\mu$ F	Murata Manufacturing Co., Ltd.	GRJ155R61A106ME12

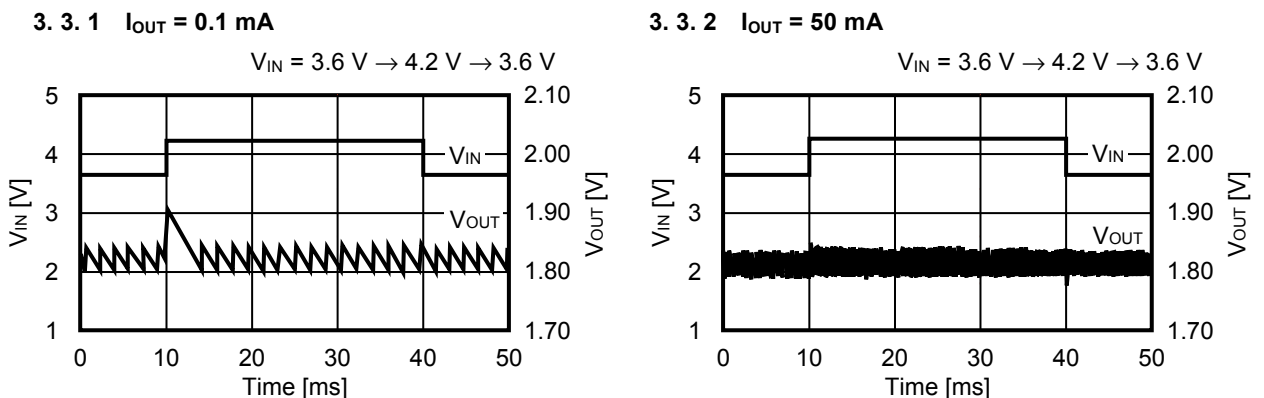
#### 3.1 电源接通 ( $V_{OUT} = 1.8\text{ V}$ , $V_{IN} = 0\text{ V} \rightarrow 3.6\text{ V}$ , $T_a = +25^\circ\text{C}$ )



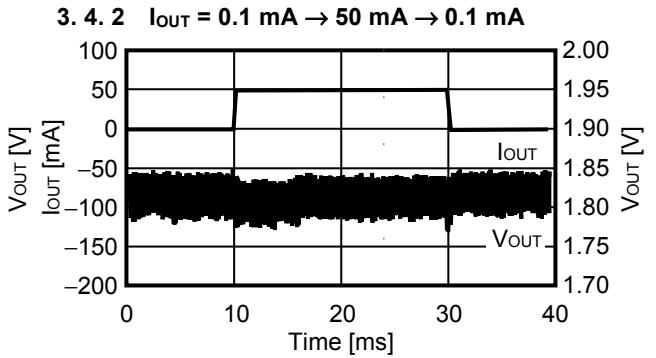
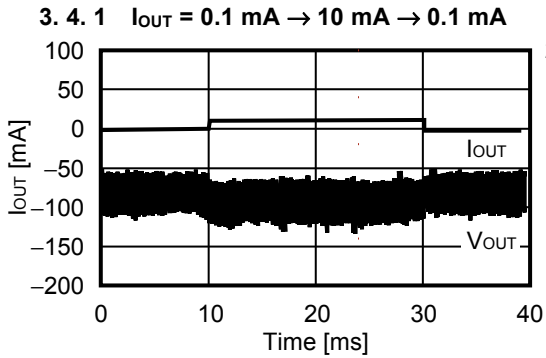
#### 3.2 EN端子过渡响应特性 ( $V_{OUT} = 1.8\text{ V}$ , $V_{IN} = 3.6\text{ V}$ , $V_{EN} = 0\text{ V} \rightarrow 3.6\text{ V}$ , $T_a = +25^\circ\text{C}$ )



#### 3.3 电源电压变动 ( $V_{OUT} = 1.8\text{ V}$ , $T_a = +25^\circ\text{C}$ )



3.4 负载变动 ( $V_{OUT} = 1.8\text{ V}$ ,  $V_{IN} = 3.6\text{ V}$ ,  $T_a = +25^\circ\text{C}$ )



■ 参考数据

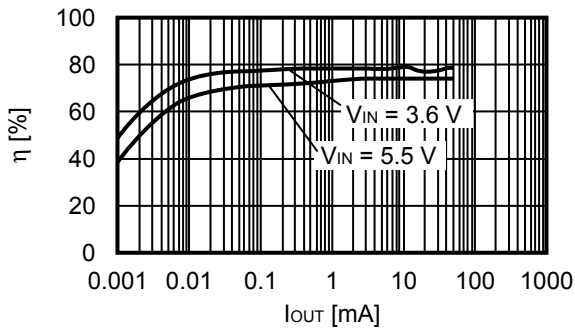
在 "■ 参考数据" 中, 使用了如表18所示的外接元器件。

表18

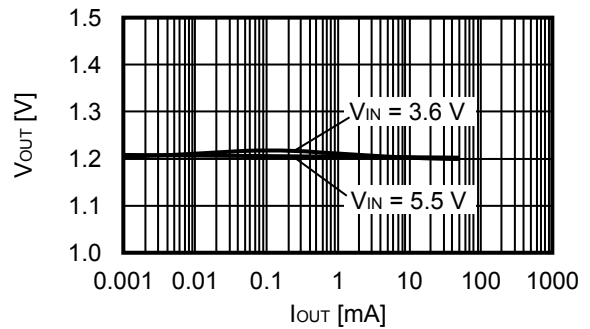
条件	电感器 (L)	输入电容器 ( $C_{IN}$ )	输出电容器 ( $C_{OUT}$ )
<1>	MBKK1608T2R2M (2.2 $\mu\text{H}$ ) TAIYO YUDEN CO.,LTD.	GRM035R60J475ME15 (4.7 $\mu\text{F}$ ) Murata Manufacturing Co., Ltd.	GRM035R60J475ME15 (4.7 $\mu\text{F}$ ) Murata Manufacturing Co., Ltd.
<2>	DFE201210S-2R2M=P2 (2.2 $\mu\text{H}$ ) Murata Manufacturing Co., Ltd.	GRJ155R61A106ME12 (10 $\mu\text{F}$ ) Murata Manufacturing Co., Ltd.	GRJ155R61A106ME12 (10 $\mu\text{F}$ ) Murata Manufacturing Co., Ltd.

1.  $V_{OUT} = 1.2\text{ V}$  (外接元器件: 条件<1>)

1.1 效率 ( $\eta$ ) - 输出电流 ( $I_{OUT}$ )

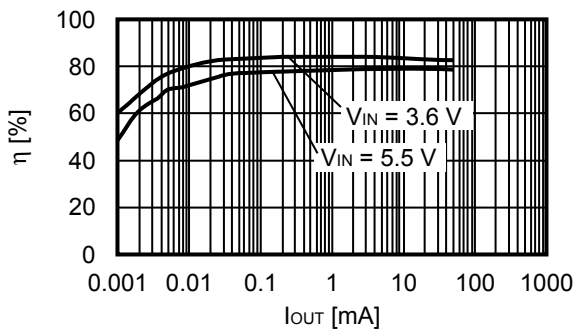


1.2 输出电压 ( $V_{OUT}$ ) - 输出电流 ( $I_{OUT}$ )

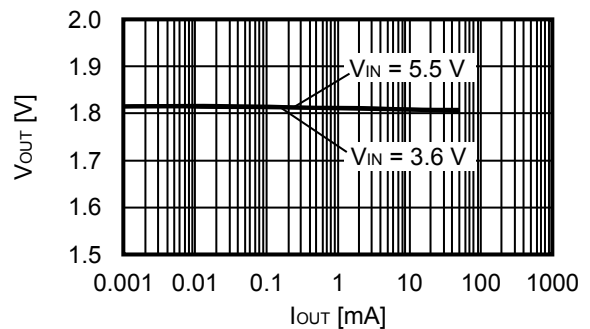


2.  $V_{OUT} = 1.8\text{ V}$  (外接元器件: 条件<1>)

2.1 效率 ( $\eta$ ) - 输出电流 ( $I_{OUT}$ )

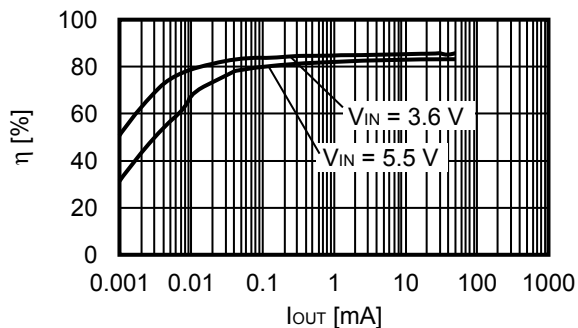


2.2 输出电压 ( $V_{OUT}$ ) - 输出电流 ( $I_{OUT}$ )

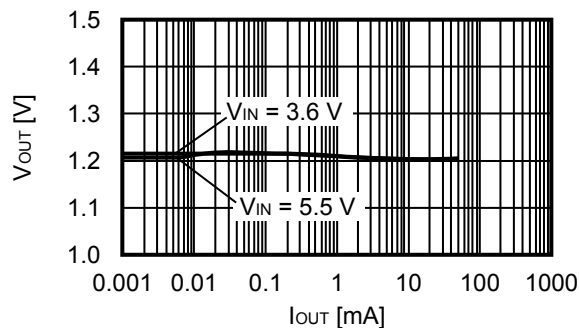


3.  $V_{OUT} = 1.2\text{ V}$  (外接元器件 : 条件<2>)

3.1 效率 ( $\eta$ ) – 输出电流 ( $I_{OUT}$ )

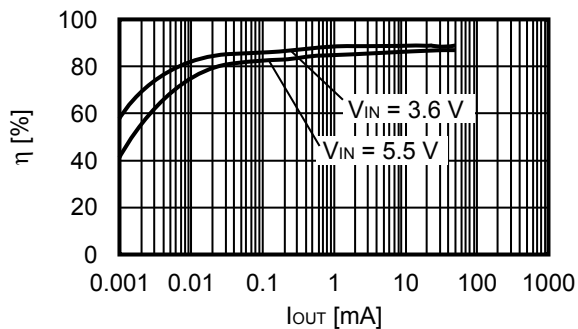


3.2 输出电压 ( $V_{OUT}$ ) – 输出电流 ( $I_{OUT}$ )

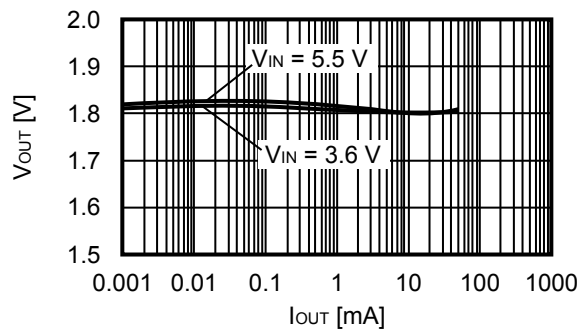


4.  $V_{OUT} = 1.8\text{ V}$  (外接元器件 : 条件<2>)

4.1 效率 ( $\eta$ ) – 输出电流 ( $I_{OUT}$ )

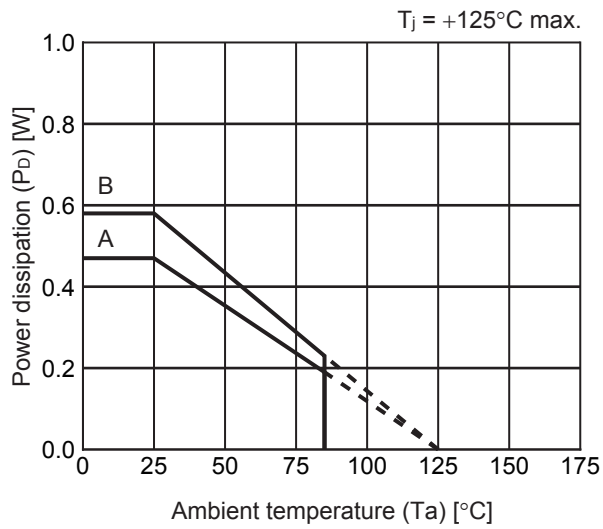


4.2 输出电压 ( $V_{OUT}$ ) – 输出电流 ( $I_{OUT}$ )



■ Power Dissipation

SNT-8A



Board	Power Dissipation ( $P_D$ )
A	0.47 W
B	0.58 W
C	—
D	—
E	—



# SNT-8A Test Board

(1) Board A

 IC Mount Area



Item	Specification	
Size [mm]	114.3 x 76.2 x t1.6	
Material	FR-4	
Number of copper foil layer	2	
Copper foil layer [mm]	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
	2	-
	3	-
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via	-	

(2) Board B



Item	Specification	
Size [mm]	114.3 x 76.2 x t1.6	
Material	FR-4	
Number of copper foil layer	4	
Copper foil layer [mm]	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
	2	74.2 x 74.2 x t0.035
	3	74.2 x 74.2 x t0.035
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via	-	

No. SNT8A-A-Board-SD-1.0



No. PH008-A-P-SD-2.1

TITLE	SNT-8A-A-PKG Dimensions
No.	PH008-A-P-SD-2.1
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	



→  
Feed direction

No. PH008-A-C-SD-2.0

TITLE	SNT-8A-A-Carrier Tape
No.	PH008-A-C-SD-2.0
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	



Enlarged drawing in the central part



No. PH008-A-R-SD-1.0

TITLE	SNT-8A-A-Reel		
No.	PH008-A-R-SD-1.0		
ANGLE		QTY.	5,000
UNIT	mm		
<b>ABLIC Inc.</b>			



※1. ランドパターンの幅に注意してください (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.).  
 ※2. パッケージ中央にランドパターンを広げないでください (1.96 mm ~ 2.06 mm)。

- 注意
1. パッケージのモールド樹脂下にシルク印刷やハンダ印刷などしないでください。
  2. パッケージ下の配線上のソルダーレジストなどの厚みをランドパターン表面から0.03 mm以下にしてください。
  3. マスク開口サイズと開口位置はランドパターンと合わせてください。
  4. 詳細は“SNTパッケージ活用の手引き”を参照してください。

※1. Pay attention to the land pattern width (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.).  
 ※2. Do not widen the land pattern to the center of the package (1.96 mm to 2.06mm).

- Caution**
1. Do not do silkscreen printing and solder printing under the mold resin of the package.
  2. The thickness of the solder resist on the wire pattern under the package should be 0.03 mm or less from the land pattern surface.
  3. Match the mask aperture size and aperture position with the land pattern.
  4. Refer to "SNT Package User's Guide" for details.

※1. 请注意焊盘模式的宽度 (0.25 mm min. / 0.30 mm typ.).  
 ※2. 请勿向封装中间扩展焊盘模式 (1.96 mm ~ 2.06 mm)。

- 注意
1. 请勿在树脂型封装的下面印刷丝网、焊锡。
  2. 在封装下、布线上的阻焊膜厚度 (从焊盘模式表面起) 请控制在 0.03 mm 以下。
  3. 钢网的开口尺寸和开口位置请与焊盘模式对齐。
  4. 详细内容请参阅 "SNT 封装的应用指南"。

No. PH008-A-L-SD-4.1

TITLE	SNT-8A-A -Land Recommendation
No.	PH008-A-L-SD-4.1
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	

## 免责声明 (使用注意事项)

1. 本资料记载的所有信息 (产品数据、规格、图、表、程序、算法、应用电路示例等) 是本资料公开时的最新信息, 有可能未经预告而更改。
2. 本资料记载的电路示例和使用方法仅供参考, 并非保证批量生产的设计。使用本资料的信息后, 发生并非因本资料记载的产品 (以下称本产品) 而造成的损害, 或是发生对第三方知识产权等权利侵犯情况, 本公司对此概不承担任何责任。
3. 因本资料记载错误而导致的损害, 本公司对此概不承担任何责任。
4. 请注意在本资料记载的条件范围内使用产品, 特别请注意绝对最大额定值、工作电压范围和电气特性等。因在本资料记载的条件范围外使用产品而造成的故障和 (或) 事故等的损害, 本公司对此概不承担任何责任。
5. 在使用本产品时, 请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规, 测试产品用途的满足能力和安全性能。
6. 本产品出口海外时, 请遵守外汇交易及外国贸易法等出口法令, 办理必要的相关手续。
7. 严禁将本产品用于以及提供 (出口) 于开发大规模杀伤性武器或军事用途。对于如提供 (出口) 给开发、制造、使用或储藏核武器、生物武器、化学武器及导弹, 或有其他军事目的者的情况, 本公司对此概不承担任何责任。
8. 本产品并非是设计用于可能对生命、人体造成影响的设备或装置的部件, 也非是设计用于可能对财产造成损害的设备或装置的部件 (医疗设备、防灾设备、安全防范设备、燃料控制设备、基础设施控制设备、车辆设备、交通设备、车载设备、航空设备、太空设备及核能设备等)。请勿将本产品用于上述设备或装置的部件。本公司事先明确标示的车载用途例外。作为上述设备或装置的部件使用本产品时, 或本公司事先明确标示的用途以外使用本产品时, 所导致的损害, 本公司对此概不承担任何责任。
9. 半导体产品可能有一定的概率发生故障或误工作。为了防止因本产品的故障或误工作而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等, 请客户自行负责进行冗长设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计。并请对整个系统进行充分的评价, 客户自行判断适用的可否。
10. 本产品非耐放射线设计产品。请客户根据用途, 在产品设计的过程中采取放射线防护措施。
11. 本产品在一般的使用条件下, 不会影响人体健康, 但因含有化学物质和重金属, 所以请不要将其放入口中。另外, 晶元和芯片的破裂面可能比较尖锐, 徒手接触时请注意防护, 以免受伤等。
12. 废弃本产品时, 请遵守使用国家和地区的法令, 合理地处理。
13. 本资料中也包含了与本公司的著作权和专有知识有关的内容。本资料记载的内容并非是对本公司或第三方的知识产权、其它权利的实施及使用的承诺或保证。严禁在未经本公司许可的情况下转载、复制或向第三方公开本资料的一部分或全部。
14. 有关本资料的详细内容等如有不明之处, 请向代理商咨询。
15. 本免责声明以日语版为正本。即使有英语版或中文版的翻译件, 仍以日语版的正本为准。

2.4-2019.07



**ABLIC**

艾普凌科有限公司  
www.ablic.com